

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-202356
 (43)Date of publication of application : 30.07.1999

(51)Int.Cl. G02F 1/1343
 G02F 1/136

(21)Application number : 10-150461 (71)Applicant : HYUNDAI ELECTRON IND CO LTD
 (22)Date of filing : 29.05.1998 (72)Inventor : LEE SEUNG HEE
 SEOK-LYUL LEE

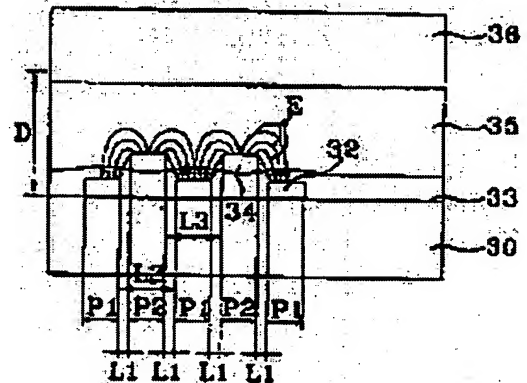
(30)Priority
 Priority number : 97 9776720 Priority date : 29.12.1997 Priority country : KR
 98 9809243 18.03.1998 KR

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE HAVING HIGH TRANSMISSION FACTOR AND HIGH APERTURE AND PRODUCTION THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To attain improvement in a transmissivity and an aperture rate by moving all liquid crystal polymers existent at the upper part of an electrode by forming opposed electrodes and pixel electrodes from transparent materials and forming a distance between both the electrodes smaller than a cell gap.

SOLUTION: On the inner side face of a first substrate 30, a first electrode (opposed electrode) 32 and a second electrode (pixel electrode) 34 for rearranging liquid crystal polymers in applying an electric field are respectively arranged while sandwiching an insulating film 33. The first and second electrodes 32 and 34 are composed of transparent conductors. The first substrate 30 and a second substrate 36 are arranged while sandwiching a liquid crystal layer 35, and a distance L1 between the first and second electrodes 32 and 34 is smaller than a cell gap D between the first and second substrates 30 and 36. Besides, width P1 of the first electrode 32 and width P2 of the second electrode 34 are formed narrower than the electrode width of a conventional liquid crystal display device. Therefore, an electric field E made parabolic rather than an in-plane electric field having the straight electric line force is formed between the first and second electrode 32 and 34 during electric field is applied.



LEGAL STATUS

- [Date of request for examination] 17.01.2000
[Date of sending the examiner's decision of rejection]
- [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-202356

(43)公開日 平成11年(1999)7月30日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号

FI

G O 2 F **1/1343**
1/136

G O 2 F 1/1343
1/136

500

審査請求 未請求 請求項の数69 OL (全 38 頁)

(21)出願番号 特願平10-150461

(22)出願日 平成10年(1998)5月29日

(31)優先權主張番号 1997/P76720

(32)優先日 1997年12月29日

(33)優先権主張国 韓国 (KR)

(31)優先權主張番号 1998/P9243

(32)優先日 1998年3月18日

(33)優先権主張国 韓国 (KR)

(71)出願人 591024111

現代電子産業株式会社

大韓民國京畿道利川市夫鉢邑牙美里山136
- 1

(72)発明者 李 升 ▲匕▼

大韓民国 京畿道 利川市 倉前洞 49-1 現代アパート 102-1206

(72)發明者 李 錫 烈

大韓民国 ソウル 廣津區 紫陽1洞
769-19

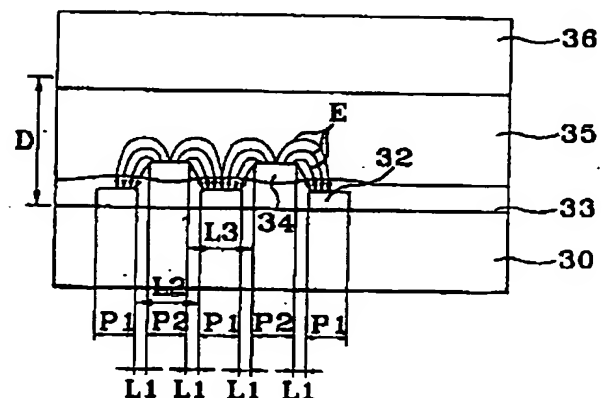
(74)代理人 弁理士 斎藤 栄一

(54) 【発明の名称】 高透過率と高開口率を有する液晶表示装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 高透過率と高開口率を有する液晶表示装置及びその製造方法を提供する。

【解決手段】互いに第 1 距離において対向配置され、それぞれが内側面と外側面を有する透明な第 1 基板及び第 2 基板と、前記第 1 基板と第 2 基板との間に配列され、多数の液晶分子を含む液晶層と、前記第 1 基板の内側面上に形成され、第 1 幅を有する第 1 電極と、前記第 1 基板の内側面上に第 2 幅を有し形成され、第 1 電極と第 2 距離において隔たり、前記第 1 電極と共に電界を形成し液晶を動かす第 2 電極とを含み、前記第 1 電極と前記第 2 電極は透明伝導体からなり前記両基板間の第 1 距離は前記両電極間の第 2 距離より大きいことを特徴とする液晶表示装置とする。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 互いに第 1 距離をおいて対向配置され、それぞれが内側面と外側面を有する透明な第 1 基板及び第 2 基板と、

前記第 1 基板と第 2 基板との間に配列され、多数の液晶分子を含む液晶層と、

前記第 1 基板の内側面上に形成され、第 1 幅を有する第 1 電極と、

前記第 1 基板の内側面上に第 2 幅を有し形成され、第 1 電極と第 2 距離をおいて隔たり、前記第 1 電極と共に電界を形成し液晶を動かす第 2 電極とを含み、

前記第 1 電極と前記第 2 電極は透明伝導体からなり、前記両基板間の第 1 距離は前記両電極間の第 2 距離より大きいことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】 前記第 1 幅及び第 2 幅は、前記両電極の間に発生する電界により前記両電極のそれぞれの上部に存在する液晶分子が全て実質的に動けるだけの幅であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3】 前記両電極間の第 2 距離は約 0.1 乃至 5 μm であることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の液晶表示装置。

【請求項 4】 前記第 1 幅に対する前記第 2 幅の比は約 0.2 乃至 4.0 であることを特徴とする請求項 3 記載の液晶表示装置。

【請求項 5】 前記第 1 電極の幅と前記第 2 電極の幅はそれぞれ約 1 乃至 8 μm であることを特徴とする請求項 4 記載の液晶表示装置。

【請求項 6】 前記液晶分子は、電界が形成されない時に前記基板の表面とそれらの長軸がほぼ平行に配列され、電界が形成される時に前記液晶分子の光軸が電界と平行または垂直をなすように配列されることを特徴とする請求項 5 記載の液晶表示装置。

【請求項 7】 前記第 1 基板の内側面上に形成された第 1 配向膜及び前記第 2 基板の内側面上に形成された第 2 配向膜を更に含み、前記第 1 配向膜は前記電界方向と所定角度をなす第 1 ラビング軸を有し、電界が形成されない時に前記液晶分子を前記第 1 ラビング軸方向に配列させ、また前記第 2 配向膜は前記電界方向と所定角度をなす第 2 ラビング軸を有し、電界が形成されない時に前記液晶分子を前記第 2 ラビング軸方向に配列させることを特徴とする請求項 5 記載の液晶表示装置。

【請求項 8】 前記液晶分子はプリティルト角を有し、そのプリティルト角は約 0° 以上、約 10° 以下であることを特徴とする請求項 7 記載の液晶表示装置。

【請求項 9】 前記第 1 配向膜のラビング軸と第 2 配向膜のラビング軸とは互いに約 180° をなすことを特徴とする請求項 8 記載の液晶表示装置。

【請求項 10】 前記第 1 基板の外側面上に配置され所定方向の偏光軸を有し前記液晶層と光学的に関連した偏光子と、前記第 2 基板の外側面上に配置され所定方向の

吸収軸を有し前記偏光子と光学的に関連した検光子とを更に含むことを特徴とする請求項 9 記載の液晶表示装置。

【請求項 11】 前記偏光子の偏光軸と前記第 1 基板の第 1 配向膜の第 1 ラビング軸とがなす角は約 0° または約 90° であり、前記検光子の吸収軸と偏光子の偏光軸とがなす角は約 90° であることを特徴とする請求項 10 記載の液晶表示装置。

【請求項 12】 前記第 1 基板の第 1 配向膜の第 1 ラビング軸と前記電界方向とがなす角が約 0° 乃至 45° ならば、前記液晶層は誘電率異方性が陰であり、前記第 1 基板の第 1 配向膜のラビング軸と前記電界とがなす角が約 45° 乃至 90° ならば、前記液晶層は誘電率異方性が陽であることを特徴とする請求項 11 記載の液晶表示装置。

【請求項 13】 前記液晶はネマチック液晶であり、前記液晶分子の屈折率異方性指数と前記第 1 距離とをかけた値が約 0.2 乃至 0.6 μm であることを特徴とする請求項 12 記載の液晶表示装置。

【請求項 14】 前記液晶はネマチック液晶であり、前記液晶分子の屈折率異方性指数と第 1 距離とをかけた値が約 0.2 乃至 0.6 μm であることを特徴とする請求項 5 記載の液晶表示装置。

【請求項 15】 前記第 1 電極は共通信号が印加される第 1 電極であり、第 2 電極は表示信号が印加される第 2 電極であることを特徴とする請求項 5 記載の液晶表示装置。

【請求項 16】 前記透明伝導体は ITO であることを特徴とする請求項 1 記載の液晶表示装置。

【請求項 17】 互いに第 1 距離をおいて対向配置され、それぞれが内側面と外側面を有する透明な第 1 基板及び第 2 基板と、

前記第 1 基板と第 2 基板との各内側面等の間に配列され、多数の液晶分子を含む液晶層と、

前記第 1 基板の内側面上に形成され、多数のストリップを含み、それぞれのストリップは第 1 幅を有するとともに第 2 距離だけ隣接したストリップから隔たる第 1 電極と、

前記第 1 基板の内側面上に形成され、前記第 1 電極ストリップの間にそれぞれ配置され、各々第 2 幅を有するとともに第 3 距離だけ隔たる多数のストリップを含み、第 1 電極のストリップと第 4 距離だけ隣接したストリップから隔たる第 2 電極と、

前記第 1 電極と前記第 2 電極を絶縁させる絶縁膜とを含み、

前記第 1 電極と前記第 2 電極はそれぞれ透明伝導体であり、

前記第 1 距離は前記第 4 距離より大きく、

前記第 2 幅は前記第 2 距離より小さく、前記第 1 幅は前記第 3 距離より小さく、

前記第 1 電極のストリップ及び第 2 電極のストリップのそれぞれの上部に存在する液晶分子が全て隣接したストリップ及びストリップ間の電界により実質的に動けるだけの幅であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 18】 前記透明伝導体は ITO であることを特徴とする請求項 17 記載の液晶表示装置。

【請求項 19】 前記第 4 距離は約 0.1 乃至 5 μm であることを特徴とする請求項 18 記載の液晶表示装置。

【請求項 20】 前記第 1 幅に対する前記第 2 幅の比は約 0.2 乃至 4.0 であることを特徴とする請求項 19 記載の液晶表示装置。

【請求項 21】 前記第 1 幅と前記第 2 幅はそれぞれ約 1 乃至 8 μm であることを特徴とする請求項 20 記載の液晶表示装置。

【請求項 22】 前記第 1 電極は、前記第 1 電極のストリップの一端を連結する第 1 ボディーを更に含むことを特徴とする請求項 21 記載の液晶表示装置。

【請求項 23】 前記第 2 電極は、前記第 2 電極のストリップの一端を連結するとともに前記第 1 電極の第 1 ボディーとオーバーラップする第 1 連結部を更に含むことを特徴とする請求項 22 記載の液晶表示装置。

【請求項 24】 前記第 1 電極は、前記第 1 電極の他端を連結する第 2 ボディーを更に含み、前記第 2 電極は、前記第 2 電極のストリップの他端を連結するとともに前記第 2 ボディーとオーバーラップする第 2 連結部を更に含むことを特徴とする請求項 23 記載の液晶表示装置。

【請求項 25】 前記第 2 電極は、前記第 1 電極の第 2 ボディーと平行で前記第 2 電極のストリップの他端を連結する第 2 連結部を更に含むことを特徴とする請求項 24 記載の液晶表示装置。

【請求項 26】 前記第 1 基板の内側面上に形成された第 1 配向膜及び前記第 2 基板の内側面上に形成された第 2 配向膜を更に含み、前記第 1 配向膜は前記電界方向と所定角度をなす第 1 ラビング軸を有し、電界が形成されない時に前記液晶分子を前記第 1 ラビング軸方向に配列させ、また前記第 2 配向膜は前記電界方向と所定角度をなす第 2 ラビング軸を有し、電界が形成されない時に前記液晶分子を前記第 2 ラビング軸方向に配列させることを特徴とする請求項 23 記載の液晶表示装置。

【請求項 27】 前記液晶分子はプリティルト角を有し、そのプリティルト角は約 0° 以上、約 10° 以下であることを特徴とする請求項 26 記載の液晶表示装置。

【請求項 28】 前記第 1 配向膜のラビング軸と第 2 配向膜のラビング軸とは互いに約 180° をなすことを特徴とする請求項 27 記載の液晶表示装置。

【請求項 29】 前記第 1 基板の外側面上に配置され所定方向の偏光軸を有し前記液晶と光学的に関連した偏光子と、前記第 2 基板の外側面上に配置され所定方向の吸収軸を有し前記偏光子と光学的に関連した検光子とを更に含むことを特徴とする請求項 28 記載の液晶表示装

置。

【請求項 30】 前記偏光子の偏光軸と前記第 1 基板の第 1 配向膜のラビング軸とがなす角は約 0° または約 90° であり、前記検光子の吸収軸と偏光子の偏光軸とがなす角は約 90° であることを特徴とする請求項 29 記載の液晶表示装置。

【請求項 31】 前記第 1 基板の第 1 配向膜の第 1 ラビング軸と前記電界とがなす角が約 0 乃至 45° ならば、前記液晶層は誘電率異方性が陰であり、前記第 1 基板の第 1 配向膜の第 1 ラビング軸と前記電界とがなす角が約 45 乃至 90° ならば、前記液晶層は誘電率異方性が陽であることを特徴とする請求項 30 記載の液晶表示装置。

【請求項 32】 前記液晶はネマチック液晶であり、液晶分子の屈折率異方性指数と第 1 距離とをかけた値が約 0.2 乃至 0.6 μm であることを特徴とする請求項 30 記載の液晶表示装置。

【請求項 33】 前記第 2 幅は第 2 距離と同じであり、第 1 幅は第 3 距離と同じであることを特徴とする請求項 17 記載の液晶表示装置。

【請求項 34】 前記第 1 幅に対する前記第 2 幅の比は約 0.2 乃至 4.0 であることを特徴とする請求項 33 記載の液晶表示装置。

【請求項 35】 前記第 1 電極の幅と前記第 2 電極の幅はそれぞれ約 1 乃至 8 μm であることを特徴とする請求項 34 記載の液晶表示装置。

【請求項 36】 前記第 1 電極は、前記第 1 電極のストリップの一端を連結する第 1 ボディーを更に含むことを特徴とする請求項 35 記載の液晶表示装置。

【請求項 37】 前記第 2 電極は、前記第 2 電極のストリップらの一端を連結するとともに前記第 1 ボディーとオーバーラップする第 1 連結部を更に含むことを特徴とする請求項 36 記載の液晶表示装置。

【請求項 38】 前記第 1 電極は、前記第 1 電極のストリップの他端を連結する第 2 ボディーを更に含み、前記第 2 電極は、前記第 2 電極のストリップの他端を連結するとともに前記第 1 ボディーとオーバーラップする第 2 連結部を更に含むことを特徴とする請求項 37 記載の液晶表示装置。

【請求項 39】 前記第 2 電極は、前記第 2 電極のストリップの他端を連結する第 2 連結部を更に含むことを特徴とする請求項 36 記載の液晶表示装置。

【請求項 40】 前記第 1 基板の内側面上に形成された第 1 配向膜及び前記第 2 基板の内側面上に形成された第 2 配向膜を更に含み、前記第 1 配向膜は前記電界方向と所定角度をなす第 1 ラビング軸を有し、また前記第 2 配向膜は前記電界方向と所定角度をなす第 2 ラビング軸を有し、電界印加時、液晶分子を前記第 2 ラビング軸方向に配列させることを特徴とする請求項 37 記載の液晶表示装置。

【請求項 4 1】 前記液晶分子はプリティルト角を有し、そのプリティルト角は約 0° 以上、約 10° 以下であることを特徴とする請求項 4 0 記載の液晶表示装置。

【請求項 4 2】 前記第 1 配向膜の第 1 ラビング軸と第 2 配向膜の第 2 ラビング軸とは互いに約 180° をなすことを特徴とする請求項 4 1 記載の液晶表示装置。

【請求項 4 3】 前記第 1 基板の外側面上に配置され、所定方向の偏光軸を有し、前記液晶と光学的に関連された偏光子と、前記第 2 基板の外側面に配置され、所定方向の吸収軸を有し、前記偏光子と光学的に関連された検光子とを更に含むことを特徴とする請求項 4 2 記載の液晶表示装置。

【請求項 4 4】 前記偏光子の偏光軸と前記第 1 基板に形成される第 1 配向膜の第 1 ラビング軸とがなす角は、ほぼ約 0° または約 90° であり、前記検光子の吸収軸と偏光子の偏光軸とがなす角は約 90° であることを特徴とする請求項 4 3 記載の液晶表示装置。

【請求項 4 5】 前記第 1 基板に形成される第 1 配向膜の第 1 ラビング軸と前記電界とがなす角が約 0 乃至 45° ならば、前記液晶層は誘電率異方性が陰のものを使用し、前記第 1 基板に形成される配向膜のラビング軸と前記電界とがなす角が約 45 乃至 90° ならば、前記液晶層は誘電率異方性が陽であることを使用することを特徴とする請求項 4 4 記載の液晶表示装置。

【請求項 4 6】 前記液晶はネマチック液晶であり、液晶分子の屈折率異方性指数と第 1 距離との積が約 0.2 乃至 $0.6 \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 4 5 記載の液晶表示装置。

【請求項 4 7】 前記第 2 幅は第 2 距離より大きく、第 3 幅は第 3 距離より大きいことを特徴とする請求項 1 7 記載の液晶表示装置。

【請求項 4 8】 前記ゲートバスライン、データバスライン及び共通信号線は、Al、Mo、Ti、W、Ta、Cr から構成された群より選択されたいずれか一つの金属または二つ以上の合金で形成されることを特徴とする請求項 1 6 記載の液晶表示装置。

【請求項 4 9】 前記液晶分子の屈折率異方性指数と第 1 距離とをかけた値が約 0.2 乃至 $0.6 \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 1 6 記載の液晶表示装置。

【請求項 5 0】 互いに第 1 距離を置いて対向配置され、それぞれが内側面と外側面を有する透明な第 1 基板及び第 2 基板と、

前記第 1 基板と第 2 基板との間に配列され、多数の液晶分子を含む液晶層と、

前記第 1 基板の内側面上に形成され、四角板状を有する第 1 電極と、

前記第 1 基板の内側面上に形成され、多数のストリップを含み、全て第 1 電極とオーバーラップするように配置され、前記ストリップのそれぞれは一定の幅を有し、これらの間に一定の第 2 距離を有するように配列され、ス

トリップ間の部分に第 1 電極が露呈されるように形成された前記第 2 電極と、

前記第 1 電極と第 2 電極を絶縁させる絶縁膜とを含み、前記第 1 電極と前記第 2 電極はそれぞれ透明伝導体であり、

前記両基板間の第 1 距離は前記絶縁膜の厚みより大きく、

前記露呈された第 1 電極の幅と第 2 電極のストリップの幅は、第 1 電極及び第 2 電極のストリップのそれぞれの上部に存在する液晶分子が全て前記互いに隣接した第 1 電極及び第 2 電極のストリップ間の電界により実質的に動けるだけの幅であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 5 1】 前記透明伝導体は ITO であることを特徴とする請求項 5 0 記載の液晶表示装置。

【請求項 5 2】 前記第 2 電極のストリップ間の距離に対する前記第 2 電極の各ストリップの幅の比は約 0.2 乃至 4.0 であることを特徴とする請求項 3 6 または 5 1 記載の液晶表示装置。

【請求項 5 3】 前記ストリップの幅は約 1 乃至 $8 \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 5 2 記載の液晶表示装置。

【請求項 5 4】 前記第 1 距離に対する前記第 2 電極のストリップ間の距離の比は約 0.1 乃至 5.0 であることを特徴とする請求項 5 3 記載の液晶表示装置。

【請求項 5 5】 前記第 2 電極は、前記ストリップの一端を連結するとともに前記第 1 電極とオーバーラップする第 1 連結部を更に含むことを特徴とする請求項 5 4 記載の液晶表示装置。

【請求項 5 6】 前記第 2 電極は、前記ストリップの他端を連結するとともに前記第 1 電極とオーバーラップする第 2 連結部を更に含むことを特徴とする請求項 5 5 記載の液晶表示装置。

【請求項 5 7】 前記第 1 基板の内側面上に形成された第 1 配向膜及び前記第 2 基板の内側面上に形成された第 2 配向膜を更に含み、前記第 1 配向膜は前記電界方向と所定角度をなす第 1 ラビング軸を有し、電界が形成されない時に前記液晶分子を前記第 1 ラビング軸方向に配列させ、また前記第 2 配向膜は前記電界方向と所定角度をなす第 2 ラビング軸を有し、電界が形成されない時に前記液晶分子を前記第 2 ラビング軸方向に配列させることを特徴とする請求項 5 5 記載の液晶表示装置。

【請求項 5 8】 前記液晶分子はプリティルト角を有し、そのプリティルト角は約 0° 以上、約 10° 以下であることを特徴とする請求項 5 0 または 5 7 記載の液晶表示装置。

【請求項 5 9】 前記第 1 配向膜の第 1 ラビング軸と第 2 配向膜の第 2 ラビング軸とは互いに約 180° をなすことを特徴とする請求項 5 8 記載の液晶表示装置。

【請求項 6 0】 前記第 1 基板の外側面上に配置され所定方向の偏光軸を有し前記液晶と光学的に関連した偏光

子と、前記第2基板の外側面上に配置され所定方向の吸収軸を有し前記偏光子と光学的に関連した検光子とを更に含むことを特徴とする請求項5記載の液晶表示装置。

【請求項61】 前記偏光子の偏光軸と前記第1基板の第1配向膜の第1ラビング軸とがなす角は約0°または約90°であり、前記検光子の吸収軸と偏光子の偏光軸とがなす角は約90°であることを特徴とする請求項60記載の液晶表示装置。

【請求項62】 前記第1基板の第1配向膜のラビング軸と前記電界とがなす角が約0°乃至45°ならば、前記液晶層は誘電率異方性が陰であり、前記第1基板の第1配向膜のラビング軸と前記電界とがなす角が約45°乃至90°ならば、前記液晶層は誘電率異方性が陽であることを特徴とする請求項61記載の液晶表示装置。

【請求項63】 前記液晶はネマチック液晶であり、液晶分子の屈折率異方性指数と第1距離とをかけた値が約0.2乃至0.6μmであることを特徴とする請求項62記載の液晶表示装置。

【請求項64】 前記液晶はネマチック液晶であり、液晶分子の屈折率異方性指数と第1距離とをかけた値が約0.2乃至0.6μmであることを特徴とする請求項50記載の液晶表示装置。

【請求項65】 前記ゲートバスライン、データバスライン及び共通信号線は、Al、Mo、Ti、W、Ta、Crから構成された群より選択されたいずれか一つの金属または二つ以上の合金で形成されることを特徴とする請求項36記載の液晶表示装置。

【請求項66】 透明な第1基板を準備する工程と、前記第1基板上に第1透明伝導体を形成する工程と、前記第1透明伝導体上部に第1金属膜を形成し、前記第1金属膜の所定部分をパターニングし、ゲートバスラインと共通信号線を形成する工程と、前記第1透明伝導体をパターニングし第1電極を形成する工程と、前記ゲートバスライン、共通信号線、第1電極が形成された第1基板上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜の所定部分上にチャネル層を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上部に第2透明伝導体を形成し、前記第2透明伝導体を前記第1電極とオーバーラップするようにパターニングし、第2電極を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上部に第2金属膜を蒸着し、所定部分をパターニングし、データバスライン、ソース及びドレインを形成する工程と、前記第1基板の結果物上部に配向膜を形成する工程と、を含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項67】 前記第1及び第2透明伝導体はITOであることを特徴とする請求項66記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項68】 透明な第1基板を準備する工程と、前記第1基板上に第1透明伝導体を形成し、所定部分をパターニングして第1電極を形成する工程と、前記第1基板上に第1金属膜を蒸着し、所定部分をパターニングし、ゲートバスラインと共通信号線を形成する工程であって、前記共通信号線は第1電極とコンタクトされるようにする工程と、

前記第1電極及び、ゲートバスライン、共通信号線が形成された第1基板上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜の所定部分上にチャネル層を形成する工程と、

前記ゲート絶縁膜上部に第2透明伝導体を形成し、前記第2透明伝導体を前記第1電極とオーバーラップするようにパターニングし、第2電極を形成する工程と、

前記ゲート絶縁膜上部に第2金属膜を蒸着し、所定部分をパターニングし、データバスライン、ソース及びドレインを形成する工程と、

前記第1基板の結果物上部に配向膜を形成する工程とを含む、

前記第1電極を形成する工程と、前記ゲートバスライン及び共通信号線を形成する工程は互いに換えて行うことができることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項69】 前記第1及び第2透明伝導体はITOであることを特徴とする請求項68記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置及びその製造方法に係わり、特に高透過率と高開口率を有する液晶表示装置及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】アクティブマトリクス型液晶表示装置の装置性能の急速な発展により、アクティブマトリクス型液晶表示装置が、平板テレビシステムまたは携帯型コンピュータ用高情報量のモニターのような応用分野に広く使用されるようになった。しかし、現在用いられるアクティブマトリクス型液晶表示装置のTN表示モードは、狭い視野角特性と遅い応答特性、特にグレースケール動作での遅い応答特性などのような根本的な問題点を有する。

【0003】このような問題点を解決するため、液晶表示素子の新しい多様な概念が提案された。例えば、一つの方法は、一つの画素がいくつかのサブ画素を有するマルチドメインのTN構造を使用することであり、他の方法は、液晶分子の物理的特性を補償するOCB (Optically Compensated birefringence) モードを使用することである。しかし、マルチドメイン方式は、視野角を向上させる点では非常に有用であるが、マルチドメインを形成するには工程が複雑で視野角の改善にも限界がある。

また、OCBモード方式は、視野角特性と応答速度面で

電気光学的性能に優れるが、バイアス電圧により液晶を安定的に調節、維持することが難しいという短所がある。

【0004】最近には、新しい表示モードとして、液晶分子を駆動させる電極が全て同一の基板上に形成されるIPS(in-plane switching)モードが提案された。(M.o h-e, M. ohta, S. Aratani, and K. Kondo in "Proceeding of the 15th International Display Research Conference", P.577 by Society for Information Display and the intrinsic of Television Engineer of Japan, 1995)

【0005】図1は単位画素領域とそれを囲む隣接した画素領域とを含む従来のIPSモードの液晶表示装置の平面図である。図1を参照して、多数のゲートバスライン11は、下部基板10上にx軸方向の第1方向に沿って互いに平行に配列される。多数のデータバスライン15はx軸と垂直なy軸方向の第2方向に沿って互いに平行に配列される。多数のゲートバスライン11とデータバスライン15とはマトリクス配列をなし、多数の単位画素領域を決めている。単位画素領域は、一對の隣接したゲートバスラインと一對の隣接したデータバスラインとの交差によって限られる領域で区切られる。

【0006】多数のゲートバスライン11と多数のデータバスライン15はこれらの間に介されたゲート絶縁膜(図示せず)によって互いに絶縁される。対向電極12は、単位画素領域内に、例えば四角枠状を有するようにそれぞれ形成される。対向電極12はゲートバスライン11のように下部基板面上に配置される。

【0007】画素電極14は、ゲート絶縁膜(図示せず)を挟んで対向電極12の上部に配列され、四角枠状の対向電極12の囲んでいる領域を分割するように文字“I”状に配列される。画素電極14は、対向電極12の囲む領域を分割するy軸方向のウェブ(web)14cと、x軸方向に対向電極12とオーバーラップする第1フランジ14a及び第2フランジ14bとからなる。ここで、第1フランジ14aと第2フランジ14bは互いに平行に配列される。画素電極のウェブ14cはy軸方向と平行に第1フランジ14a及び第2フランジ14b間を連結するとともに、対向電極12で囲まれた領域を二つの領域に分割する。

【0008】薄膜トランジスタ16はゲートバスライン11とデータバスライン12との交差部分に設けられる。この薄膜トランジスタ16は、ゲートバスライン11から延びたゲート電極、データバスライン15から延びて形成されたドレイン電極、画素電極14から延びたソース電極及びゲート電極の上部に形成されたチャンネル層17を含む。

【0009】蓄積キャパシタCstは、対向電極12と画素電極14とがオーバーラップする部分で形成される。図1には示していないが、カラーフィルタ(図示せず)を備えた上部基板(図示せず)は下部基板10上に

所定距離を有して対向、配置される。ここで、ゲートバスライン11、対向電極12、画素電極14及びデータバスライン15は、アルミニウム、チタン、タンタル、クロム及びこれらの組合せから構成された群より選択された少なくとも一つ以上の金属で形成される。

【0010】このようなIPSモードの液晶表示装置の製造方法を図1及び図2を参照して説明する。図2は、図1を202-202'線で切断して示した断面図であり、下部基板10上に金属膜を、例えば2500乃至3500Åの厚みに形成する。金属膜は上記のアルミニウム、チタン、タンタル、クロム及びこれらの組合せから構成された群より選択された少なくとも一つ以上の金属で形成される。次いで、金属膜の所定部分をパターニングし、ゲートバスライン11と対向電極12を形成する。図2には対向電極12のみが見える。そして、ゲートバスライン11及び対向電極12が形成された下部基板10上部にゲート絶縁膜13を形成する。次に、薄膜トランジスタ16のチャンネル層17をゲート絶縁膜13の所定部分に形成する。その後、アルミニウム、チタン、タンタル、クロムなどのような不透明金属膜を、チャンネル層17の形成されたゲート絶縁膜13上部に、例えば4000乃至4500Åの厚みに形成する。次いで、不透明金属膜の所定部分をパターニングし、画素電極14及びデータバスライン15を形成する。図2には画素電極14のみが見える。その後、下部基板10の結果物表面に第1配向膜19を形成する。

【0011】下部基板10上に上部基板20を所定距離dをおいて配列する。ここで、従来の液晶表示装置では、下部及び上部基板10、20間の距離(以下、セルギャップという)dが画素電極のウェブ14c(以下、画素電極14と略称する)と対向電極12との距離1より大きくなっている。これは画素電極14と対向電極12との間に形成される電界が、基板10、20の表面とほぼ平行な形態を有するようにするためである。

【0012】カラーフィルタ21を下部基板10と対向する上部基板20の内側面に形成する。そして、第2配向膜22をカラーフィルタ21上部に形成する。ここで、第1及び第2配向膜19、22は、画素電極14と対向電極12との間に電界が形成されない時、液晶分子(図示せず)をその長軸が下部基板10表面にほぼ平行をなすように配列させる役割をする。そして、第1及び第2配向膜19、22はゲートバスライン11と所定角度をなすようにラビング処理されている。そして図面に示していないが、下部基板10の外側面に偏光子(図示せず)を取り付け、上部基板20の外側面に検光子(図示せず)を取り付ける。

【0013】このようなIPSモードの液晶表示装置は、ゲートバスライン11のうちいずれか一つに走査信号が印加され、データバスライン15に表示信号が印加されれば、信号が印加されたゲートバスライン11とデ

ータバスライン 15 との交差点の付近に位置する薄膜トランジスタ 16 がターンオンされる。すると、データバスライン 15 の表示信号は薄膜トランジスタ 16 を通じて画素電極 14 に伝えられ、対向電極 12 には、続けて共通信号が印加される。したがって、電界が対向電極 12 と画素電極 14 との間で発生する。

【0014】この時、図 2 に示すように、対向電極 12 と画素電極 14 との距離 l は、セルギャップ d より大きい。ため、ほぼ基板表面に平行な形態の電界が EF が形成される。これにより、液晶内の液晶分子（図示せず）は、その誘電率異方性特性により、その光軸が電界 EF と平行に捻れる。したがって、使用者は、いずれの方向からも液晶分子の長軸を見るようになり、液晶表示装置の視野角が改善される。

【0015】しかし、上述したような IPS-LCD は次のような問題点が存在する。まず、IPS モードの液晶表示装置は、図 1 及び図 2 に示すように、光が透過する面、即ち下部基板 10 上にアルミニウムなどのような不透明金属からなる対向電極 12 と画素電極 14 が配置される。これにより、液晶表示装置の開口面積が減少し、透過率が低下する。またこの結果から適正な輝度を得るためには、強いバックライトを使用する必要があり、このために、消費電力が大きくなるという問題点が生じる。

【0016】このような問題点を解決するため、対向電極 12 と画素電極 14 を透明物質で形成する方法が提案されている。しかしこの方法は、開口率面では少し増大するが、透過率面ではそんなに優れない。即ち、インプレーン電界(in-plane field)を形成するためには、対向電極 12 と画素電極 14 間の距離 l をセルギャップ d に比べ相対的に大きく設定すべきであり、適正な強さの電界を得るためには、電極 12, 14 が比較的広い幅、例えば 10 乃至 20 μm ほどの幅を有するべきである。しかし、このような構造を有するため、電極 12, 14 間には、基板とほぼ平行な電界が形成されるが、広い幅を有する電極 12, 14 上部の大部分の領域にある液晶には電界の影響が及ばなくて、等電位面が生じるようになる。これにより、電極上部の液晶分子が初期の配列状態を維持するので、透過率は殆ど改善されない。

【0017】図 3 は、図 1 と図 2 の構造を有する従来の液晶表示装置で、電界が形成された後、時間の経過による透過率の変化をシミュレーションした結果を示す図である。ここで、上部のグラフは透過率の変化を示し、下部のグラフは対向電極及び画素電極間から発生した等電気力線の分布を示す。また、図 3 で参照番号 25 は液晶分子を表す。液晶表示装置は対向電極と画素電極が不透明金属であり、対向電極と画素電極との距離が約 20 μm 、画素電極と対向電極の幅がそれぞれ約 10 μm 、セルギャップが約 4.5 μm 、第 1 配向膜のラビング軸と電界とがなす角が約 22° である。また画素電極に印加

された電圧は 8 V であった。

【0018】図 3 から知れるように、電圧を印加し 100 ms の時間が経った後には約 23 % の透過率を示し、電圧を印加し 100 ms の時間が経つ以前には約 20 % 以下の透過率を示す。また、上記のシミュレーション結果によれば、図 3 に示すように、電界が形成される時、対向電極 12 と画素電極 14 が不透明な物質で形成されていて、光が透過できない。

【0019】一方、対向電極 12 と画素電極 14 を上記の幅を有する透明な物質で形成しても、図 3 のシミュレーション結果とほぼ同一に対向電極 12, 画素 14 の上部には、電界の強さが微弱で等電位線の密度が小さく現れる。したがって、両電極の上部に存在する液晶分子は殆ど動くことができず、両電極の上部の透過率はほぼ“0”に近くなる。このような結果は、両電極 12, 14 を上記した幅を有する透明電極に作る場合も不透明電極に作る場合とほぼ同一な透過率を示すようになることが知れる。

【0020】また、上述した液晶表示装置の製造方法的な面では、対向電極 12 がゲートバスライン 11 と同時に形成され、画素電極 14 がデータバスライン 15 と同時に形成されるため、対向電極 12 と画素電極 14 は下部基板 10 表面またはゲート絶縁膜 13 表面に対し 3000 Å 以上の高さを有する。このような対向電極 12 と画素電極 14 の高さによって、液晶表示装置の下部基板 10 表面は甚だしい段差を有するようになり、別の平坦化工程が要求される。このような平坦化工程が行なわれないと、以後に行われる配向膜のラビング工程を進めるのに難しさがある。

【0021】

【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明の目的は、液晶表示装置の開口率を改善するとともにその透過率を増大させることにある。また、本発明の目的は、液晶表示装置の電極面を通じて光が透過するようにして透過率を更に増大させることにある。また、本発明の他の目的は、別の平坦化工程なく、下部基板の構造物の段差を減らすことにある。

【0022】

【課題を解決するための手段】本発明の課題を解決するため、本発明による液晶表示装置は、互いに第 1 距離において対向配置され、それぞれが内側面と外側面を有する透明な第 1 基板及び第 2 基板と、前記第 1 基板と第 2 基板との間に配列され、多数の液晶分子を含む液晶層と、前記第 1 基板の内側面上に形成され第 1 幅を有する第 1 電極と、前記第 1 基板の内側面上に第 2 幅を有し形成され、第 1 電極と第 2 距離において隔たり、前記第 1 電極と共に電界を形成し液晶を動かす第 2 電極とを含み、前記第 1 電極と前記第 2 電極は透明伝導体からなり、前記両基板間の第 1 距離は前記両電極間の第 2 距離より大きいことを特徴とする。

【0023】また本発明による液晶表示装置は、互いに第1距離において対向配置され、それぞれが内側面と外側面を有する透明な第1基板及び第2基板と、前記第1基板と第2基板との各内側面等の間に配列され、多数の液晶分子を含む液晶層と、前記第1基板の内側面上に形成され、前記第2方向と平行に分岐された多数のストリップを含み、それぞれのストリップは第1幅を有するとともに第2距離だけ隣接したストリップから隔たる第1電極と、前記第1基板の内側面上に形成され、前記第2電極は前記ストリップの間にそれぞれ配置され、第2幅を有するとともに第3距離だけ隔たる多数のストリップを含み、第1電極のストリップと第4距離だけ隔たる第2電極と、前記第1電極と前記第2電極を絶縁させる絶縁膜とを含み、前記第1電極と前記第2電極はそれぞれ透明伝導体であり、前記第1距離は前記第4距離より大きく、前記第2幅は前記第1距離より小さく、前記第1幅は前記第2距離より小さく、前記第1幅及び前記第2幅は、第1電極のストリップ及び第2電極のストリップのそれぞれの上部に存在する液晶分子が全て隣接したストリップ及びストリップ間の電界により実質的に動けるだけの幅であることを特徴とする。

【0024】また、本発明による液晶表示装置は、互いに第1距離において対向配置され、それぞれが内側面と外側面を有する透明な第1基板及び第2基板と、前記第1基板と第2基板との間に配列され、多数の液晶分子を含む液晶層と、前記第1基板の内側面上に形成され、四角板状を有する第1電極と、前記第1基板の内側面上に形成され、第2方向と平行に分岐された多数のストリップを含み、全て第1電極とオーバーラップするように配置され、前記ストリップのそれぞれは一定の幅を有しこれら間に一定の第3距離を有するように配列され、ストリップ間の部分に第1電極が露呈されるように形成された前記第2電極と、前記第1電極と第2電極を絶縁させる絶縁膜とを含み、前記第1電極と前記第2電極はそれぞれ透明伝導体であり、前記両基板間の第1距離は前記絶縁膜の厚みより大きく、前記露呈された第1電極の幅と第2電極のストリップの幅は、第1電極及び第2電極のストリップのそれぞれの上部に存在する液晶分子が全て前記互いに隣接した第1電極及び第2電極のストリップ間の電界により実質的に動けるだけの幅であることを特徴とする。

【0025】本発明による液晶表示装置の製造方法は、透明な第1基板を準備する工程と、前記第1基板上に第1透明伝導体を形成する工程と、前記第1透明伝導体上部に第1金属膜を形成し、前記第1金属膜の所定部分をパターニングし、ゲートバスラインと共通信号線を形成する工程と、前記第1透明伝導体をパターニングし第1電極を形成する工程と、前記ゲートバスライン、共通信号線、第1電極が形成された第1基板上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜の所定部分上にチ

ヤネル層を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上部に第2透明伝導体を形成し、前記第2透明伝導体を前記第1電極とオーバーラップするようにパターニングし、第2電極を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上部に第2金属膜を蒸着し、所定部分をパターニングし、データバスライン、ソース及びドレインを形成する工程と、前記第1基板の結果物上部に第1配向膜を形成する工程と、を含むことを特徴とする。

【0026】また本発明による液晶表示装置の製造方法は、透明な第1基板を準備する工程と、前記第1基板上に第1透明伝導体を形成し、所定部分をパターニングして第1電極を形成する工程と、前記第1基板上に第1金属膜を蒸着し、所定部分をパターニングし、ゲートバスラインと共通信号線を形成する工程であって、前記共通信号線は第1電極とコンタクトされるようにする工程と、前記第1電極及び、ゲートバスライン、共通信号線が形成された第1基板上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜の所定部分上にチャネル層を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上部に第2透明伝導体を形成し、前記第2透明伝導体を前記第1電極とオーバーラップするようにパターニングし、第2電極を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上部に第2金属膜を蒸着し、所定部分をパターニングし、データバスライン、ソース及びドレインを形成する工程と、前記第1基板の結果物上部に第1配向膜を形成する工程とを含み、前記第1電極を形成する工程と、前記ゲートバスライン及び共通信号線を形成する工程は互いに換えて行うことができることを特徴とする。

【0027】本発明によれば、対向電極と画素電極を透明な物質で形成し、電極間の距離は多数のフリンジ電界が発生できるようにセルギャップより小さく形成し、駆動電極の幅は、その両側に発生するフリンジ電界で液晶分子が全て動けるだけ充分に狭く形成することにより、電極上部に存在する液晶分子を全て動かす。したがって、従来のIPSモードの液晶表示装置に比べ透過率が大きく改善される。また、ITO層は一般的な不透明金属膜より浅い深さに蒸着されるため、下部基板の構造物の段差を減らすことができる。

【0028】

【発明の実施の形態】以下、添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施の形態を詳細に説明する。

【0029】本発明はIPSモードの液晶表示装置の透過率及び開口率を改善させるため、図4に示すように、内側面と外側面を有する第1基板、即ち、下部基板30の内側面上に電界の印加時に液晶分子を再配列させる第1電極32と第2電極34が絶縁膜33を挟んでそれぞれ配置される。第1電極32と第2電極34は透明伝導体からなる。第1基板30と対向する第2基板36も、即ち、上部基板の内側面と外側面を有し、第1基板30と第2基板36は、これらの内側面が向き合うように液

晶層35を挟んで配列される。ここで、第1基板30と第2基板36との間隔であるセルギャップをDに表す。本発明で、第1電極32と第2電極34を透明伝導体で形成することは、単位画素面積で開口される面積を大きくし、開口率及び透過率を増大させるためである。

【0030】下記で説明する特定の実施の形態において、第1電極32と第2電極34は、第1距離L1において互いに隔たったりオーバーラップすることもできる。第1電極32と第2電極34との第1距離L1は、第1基板30と第2基板36とのセルギャップDより小さい。第1電極32の幅P1と第2電極34の幅P2は従来の液晶表示装置での電極幅より狭い幅に形成される。

【0031】上記の三つの条件等は、単独かつ二つ以上の組み合わせにより本発明の実施の形態に適用することができる。例えば、第1電極32の幅P1と第2電極34の幅P2は互いに同一であったり、或いは異なることもできる。また、第1電極32と隣接した第1電極32のとの距離L2は、第2電極34の幅P2と同一であったり或いは異なることもでき、第2電極34と隣接した第2電極34のとの距離L3も第1電極32の幅P1と同一であったり或いは異なることもできる。これらの幅及び距離間の関係は、本発明の実施の形態等で詳細に説明する。

【0032】上記した側面等は次のような状況のため部分的に生ずる。第1電極32と第2電極34との距離L1をセルギャップDより小さくすれば、電界印加の間に、第1電極32と第2電極34の間には直線上の電気力線を有するインプレーン電界(in-plane field)よりは放物線状の電界(以下、放物線という)Eが形成される。この時、電極32、34のそれぞれは、両電極に電圧の印加時、両電極の間で形成された電界の等電位線が、両電極の上部にもぎっしりと形成され、両電極上部に存在する液晶分子を十分に動かすのに必要な幅を有するべきである。このような点からみれば、両電極の幅をできるだけ狭く形成することが望ましい。しかし、その幅をあまり狭くする場合、形成された電界は両電極上部の液晶を駆動させる十分な強さを有しない。したがって、両電極は所定範囲以上の幅を有するべきである。このような状況を考慮して電極の幅は決められる。

【0033】合わせて、電界が形成される時に液晶分子が傾いて光が漏洩されるように偏光子(図示せず)を上記した構造に更に加えることもできる。これにより、電極の上部を含む全開口領域で液晶分子が動くので、透過率が大きく改善される。ここで、参照符号Eは、第1電極32と第2電極34との間に電界が形成される時の電気力線を表す。

【0034】〈第1の実施の形態〉まず、図5、図6及び図7に示すように、多数のゲートバスライン41a、41bは、下部または第1基板40上に一定間隔を有

し、図面のx軸方向に延び、配列される。また、多数のデータバスライン47a、47bもやはり下部基板40上に一定間隔を有し、図面のy軸方向に延び、配列される。一对のゲートバスライン41a、41bと一对のデータバスライン47a、47bとにより液晶表示装置の単位画素が限られる。図には一对のゲートバスライン41a、41bと一对のデータバスライン47a、47bのみが示されている。ここで、単位画素の大きさは従来と同一である。そして、ゲートバスライン41a、41bとデータバスライン47a、47bの間にはゲート絶縁膜44が介され、お互いを絶縁させる。

【0035】共通信号線42は、ゲートバスライン41a、41bと平行な方向、即ちx軸方向に延び、一对のゲートバスライン41a、41bの間に位置し、ゲートバスライン41aよりは前のゲートバスライン41b(previous gate busline)とものと近接な位置に配置される。ここで、ゲートバスライン41a、41b、共通信号線42及びデータバスライン47a、47bはRC遅延(RC delay)を減らすため、比較的伝導特性が優れたAl、Mo、Ti、W、Ta、Crから構成された群より選択されたいずれか一つの金属膜または二つ以上の合金膜で形成できる。本実施の形態では、MoW合金膜が使用される。

【0036】第1電極、即ち対向電極43は、下部基板40の単位画素領域にそれぞれ形成される。ここで、対向電極43はゲートバスライン41と同一面、即ち下部基板40表面に形成され、共通信号線42とはコンタクトされるように形成される。対向電極43は共通信号線42とコンタクトされ共通信号の印加を受ける。対向電極43は、透明伝導体、例えばITO(indium tin oxide)から形成され、ゲートバスライン41a、41bと平行で共通信号線42とコンタクトされるボディー43aと、ボディー43aから逆y軸方向に延びる多数の、例えば八つのストリップ43bを含む。即ち、対向電極43はその一段が前記ボディー43aにより閉じており、その他段が開けているコーム(comb)状に形成される。本実施の形態1で単位画素当たりストリップは八つである。ここで、それぞれのストリップ43bは一定の幅P11を有し、それぞれのストリップは一定の距離L11を置いて隔たっている。それぞれのストリップ43bの幅P11は、以後に形成される画素電極の幅及びそれとの距離を考慮して、従来の対向電極に比べ多少狭く形成される。

【0037】第2電極、即ち画素電極46もやはり下部基板40の単位画素領域にそれぞれ形成される。この時、画素電極46は対向電極43と重なるように、ゲート絶縁膜44上部に形成される。画素電極46は対向電極43のように透明伝導体、例えばITOからなる。画素電極46は、対向電極43のボディー43aとオーバーラップするボディー46aと、ボディー46aから逆

y 軸方向に延びてストリップ状を有する多数の、例えば単位画素当たり七つのストリップ 46 b とを含む。即ち、画素電極 46 はその一段が、前記ボディー 43 a により閉じており、その他段が開けているコーム (comb) 状に形成される。この時、ストリップ 46 b は一定の幅 P 12 を有し、一定の距離 L 12 を有し配列される。そして、ストリップ 46 b は対向電極のストリップ 43 b の間に位置する。図 7 に示したように、画素電極のストリップ 46 b は、対向電極のストリップ 43 b との間にゲート絶縁膜 44 を介在し、互いに交代する構造で配列されている。

【0038】図 6 に示すように、対向電極 43 はそのストリップ 43 b の両先端がゲートバスライン 41 a と平行な、各々の対応するボディー 43 a、43 c によって結束された構造を有する。画素電極 46 もそのストリップ 46 b の両先端がゲートバスライン 41 a と平行な、各々の対応するボディー 46 a、46 c によってまとめられるように変形できる。また、図には示していないが、選択的に対向電極 43 のストリップ 43 b の先端のみがまとめられることができ、画素電極 46 のストリップ 46 b の先端のみがまとめられるように変形できる。また、画素電極 46 のストリップ 46 b はボディー 46 c のみによってまとめられ、ボディー 46 a が除去される形態にも変形できる。

【0039】本実施の形態では、画素電極 46 のストリップ 46 b の幅 P 12 は対向電極 43 のストリップ 43 b 間の距離 L 11 より狭く形成される。したがって、画素電極 46 のストリップ 46 b は、対向電極 43 のストリップ 43 b と所定距離 L 11 だけ隔たる。それで、画素電極 46 のストリップ 46 b は、対向電極 43 のストリップ 43 b 間の空間の中央部を庇って配置され、画素電極 46 のストリップ 46 b とそれに隣接した対向電極 43 のストリップ 43 b は L 11 である。その距離 L 11 は図 7 のセルギャップ d 11 より少ない。例えば、単位画素の大きさが $110\mu\text{m} \times 330\mu\text{m}$ である時、距離 L 11 が $0.1\mu\text{m}$ 以上、 $5\mu\text{m}$ 以下となるように形成される。対向電極 43 のストリップ 43 b と画素電極 46 のストリップ 46 b の幅は、これらの間に形成される放物線電界により電極 43 b、46 b 上部の液晶分子が全て動けるだけで形成されるべきである。例えば、単位画素の大きさが $110\mu\text{m} \times 330\mu\text{m}$ であり、対向電極 43 のストリップ 43 b と画素電極 46 のストリップ 46 b がそれぞれ八つ、七つである時、これら 43 b、46 b の幅は、1 乃至 $8\mu\text{m}$ ほど、より望ましくは 2 乃至 $5\mu\text{m}$ ほどとなることができる。

【0040】一方、単位画素の大きさと、対向電極 43 のストリップ 43 b 及び画素電極 46 のストリップ 46 b の数とにより、対向電極 43 のストリップ 43 b と画素電極 46 のストリップ 46 b の幅及び距離は流動的でありうる。ところが、ストリップ 43 b、46 b の幅

は、ストリップ 43 b、46 b 間の放物線電界によりストリップ 43 b、46 b 上部に存在する液晶分子が全て動けるだけの幅でなければならない。望ましくは、対向電極 43 のストリップ 43 b の幅 P 11 に対する画素電極 46 のストリップ 46 b の幅 P 12 の比は 0.2 乃至 4 程となる。

【0041】スイッチング素子の薄膜トランジスタ ("TFT") 50 は、ゲートバスライン 41 a とデータバスライン 47 a との交差点の上部または付近にそれぞれ形成される。薄膜トランジスタ 50 は、ゲートバスライン 41 a 上部に形成されるチャネル層 45 と、チャネル層 45 の一側とオーバーラップしデータバスライン 47 a から延びたドレイン電極 48 と、チャネル層 45 の他側とオーバーラップし画素電極 46 の所定部分とコンタクトされるソース電極 49 とを含む。

【0042】蓄積キャパシタ C s t は対向電極 43 と画素電極 46 とがオーバーラップする部分で発生する。この蓄積キャパシタ C s t は一つのフレームにデータ信号を維持させる役割をし、本実施の形態では、対向電極 43 のボディー 43 a と画素電極 46 のボディー 46 a とがオーバーラップする部分で発生する。上記した構造を有する下部基板 40 上には、所定距離 (以下、セルギャップという) d 11 をおいて上部基板 52 が配置される。上部基板 52 の下部基板 40 に対向する面にはカラーフィルタ 54 が形成される。

【0043】第 1 及び第 2 配向膜 55、56 は、下部基板 40 と上部基板 52 の内側表面にそれぞれ形成される。この時、配向膜 55、56 は、液晶分子 (図示せず) を一定方向に配列させる表面を有する。また、第 1 及び第 2 配向膜 55、56 は液晶分子が 0 乃至 10° のプリティルト角を有するように処理されている。下部基板 40 に形成される第 1 配向膜 55 は x 軸方向と ϕ だけの角度差を有するようにラビングされ、上部基板 52 に形成される第 2 配向膜 56 は第 1 配向膜 55 のラビング方向と 180° の角度差を有するようにラビングされる。

【0044】さらに、図 7 を参照すれば、これら配向膜 55、56 の間には液晶 57 が介される。この時、液晶 57 はネマチック液晶で、ツイストが可能な構造を有する。そして、液晶 57 の屈折率異方性 Δn はセルギャップ d 11 との積が 0.2 ないし $0.6\mu\text{m}$ となるように設定され、誘電率異方性 $\Delta \epsilon$ は第 1 配向膜 55 のラビング軸と x 軸とがなす角によって決まる。誘電率異方性 $\Delta \epsilon$ の決定は以下に詳細に説明する。

【0045】偏光子 58 は液晶 57 と光学的に関連し、下部基板 40 の外側面に位置する。検光子 59 は偏光子 58 と光学的に関連し、上部基板 52 の外側面に位置する。この時、偏光子 58 の偏光軸と検光子 59 の吸収軸とは、ほぼ 90° をなす。ここで、偏光子 58、偏光軸 58 a、検光子 59、吸収軸 59 a、第 1 及び第 2 配向

膜 5 5, 5 6 のラビング軸 5 5 a, 5 6 a の関係に対し、図 8 及び図 9 を参照して説明する。

【0046】図 8 を参照して、偏光子 5 8 の偏光軸 5 8 a と x 軸（電界方向）とは、 ϕ° だけの角度差、即ちストリップ 4 3 b, 4 6 b とは、 $90 \sim \phi^\circ$ だけの角度差を有する。検光子 5 9 の吸収軸 5 9 a は、偏光子 5 8 の偏光軸 5 8 a とほぼ 90° をなす。第 1 配向膜 5 5 は、ラビング軸 5 5 a が偏光子 5 8 の偏光軸 5 8 a とほぼ 0° をなすようにラビングされる。第 2 配向膜 5 6 は、ラビング軸 5 6 a が第 1 配向膜 5 5 のラビング軸 5 5 a と 180° の角度をなすようにラビングされる。または、図 9 に示すように、偏光子 5 8 の偏光軸 5 8 a と第 1 配向膜 5 5 のラビング軸 5 5 b とがほぼ 90° をなすように設けることができる。即ち、偏光子 5 8 の偏光軸 5 8 a と検光子 5 9 の吸収軸 5 9 a とは図 8 とほぼ同一にし、第 1 配向膜 5 5 のラビング軸 5 5 b と偏光子 5 8 の偏光軸 5 8 a とがほぼ 90° をなすように設けることもできる。この時、第 2 配向膜 5 6 のラビング軸 5 6 b と第 1 配向膜 5 5 の配向軸とは 180° の角度差を有する。

【0047】液晶 5 7 は、電界と液晶分子の長軸が垂直に配列される誘電率異方性が陰である液晶を使用したリ、又は電界と液晶分子の長軸とが平行するように配列される誘電率異方性が陽である液晶を使用することができる。この時、図 8 のような配列で、第 1 配向膜 5 5 のラビング軸 5 5 a と x 軸とのなす角 ϕ が $0 \sim 45^\circ$ ならば、誘電率異方性が陰である液晶を使用し、 $45 \sim 90^\circ$ ならば誘電率異方性が陽である液晶を使用する。ここで、配向膜のラビング軸により誘電率異方性特性の異なる液晶を使用することは液晶表示装置の最大透過率を得るためである。

【0048】これをより詳細に説明すれば、一般的な IPS モードの透過率は次の式のように表れる。

$$T = T_0 \cdot \sin^2 \left((2\chi) \cdot \sin^2 \left(\pi \cdot \Delta n d / \lambda \right) \right) \dots \quad (式 1)$$

T_0 : 参照(reference)

光に対する透過率

χ : 液晶分子の光軸と偏光子の偏光軸とがなす角

Δn : 屈折率異方性

d : 上、下基板間の距離またはギャップ（液晶層の厚み）

λ : 入射される光波長

【0049】式 1 によれば、液晶表示装置は、偏光子 5 8 の偏光軸 5 8 a と液晶分子 5 7 a の光軸とがなす角 χ が $\pi/4$ (45°) であり、 $\Delta n d / \lambda$ が $1/2$ である時に最大となる。これを満足させるためには、液晶分子の $\Delta n d$ が $\lambda/2$ で、電界が形成される時に液晶分子 5 7 a が電界方向に捻れる角度が 45° 以上でなければな

らない。

【0050】もしかして、配向膜 5 5 のラビング軸 5 5 a と電界（x 軸方向）とがなす角 ϕ が、 45° 以下ならば、誘電率異方性が陽である液晶の使用時には液晶分子は 45° 以下にしか捻れないので、最大透過率に至ることができない。一方、誘電率異方性が陰である液晶を使用する時には、液晶分子は $90 \sim \phi^\circ$ (ϕ は 45° 以下の角) だけ捻れるので、最大透過率に至るようになる。また、配向膜 5 5 のラビング軸 5 5 a と電界（x 軸方向）とがなす角 ϕ が 45° 以上ならば、誘電率異方性が陽である液晶の使用時に液晶分子は 45° 以上の角だけ捻れるようになる。これにより、電界と平行に捻れる動き中に 45° 区間を通るので、最大透過率に至る。ところが、誘電率異方性が陰である液晶を使用する時には液晶分子は $90 \sim \phi^\circ$ (ϕ は 45° 以上の角) だけ捻れるので、最大透過率を得られなくなる。

【0051】例えば、第 1 配向膜 5 5 のラビング軸と x 軸とがなす角 ϕ が 30° で、誘電率異方性が陽である液晶を使用すれば、電界が形成される時に電界と液晶分子の長軸が平行に配列されるために 30° だけ捻れるはずである。この時、光は漏洩されるが、偏光軸と液晶分子とがなす角が 30° にしかならず、最大透過率に至ることができない。反対に、誘電率異方性が陰である液晶を使用すれば、電界と液晶分子の長軸が垂直に配列されるために 60° だけ捻れるようになる。この時、 60° だけ捻れる動き中に 45° 区間を通るので、液晶表示装置は最大透過率に至るのである。

【0052】以下、上記した液晶表示装置の製造方法を説明する。図 10 を参照して、透明金属膜（図示せず）の ITO 層は、下部基板上に 400 乃至 1000 \AA の厚みに下部基板 40 上部に形成される。次に、金属膜、例えば MoW 膜が 2500 乃至 3500 \AA の厚みに ITO 層上部に形成される。次いで、フォトリソグラフィ方式によって、金属膜の所定部分がパターニングされ、ゲートバスライン 41 a, 41 b 及び共通信号線 42 が形成される。その後、露呈された ITO 層は所定形態、即ち所定のストリップを有するコーン状にパターニングされ対向電極 43 が形成される。ここで、対向電極 43 は、上述したように、対向電極 43 のストリップ 43 b は一定の幅 $P11$ を有し、一定の間隔 $L11$ だけ隔たるように形成される。また、対向電極 43 は共通信号線 42 とコンタクトされるように形成される。ここで、下部基板 40 は透明なガラス基板であって、その表面にアルカリイオンなどの浸透を防止するためにバッファ用保護膜が蒸着されていることができる。

【0053】また、図面には示されていないが、金属膜が下部基板 40 の表面に形成された後、所定部分パターニングされゲートバスライン 41 a, 41 b 及び共通信号線 43 が下部基板 40 の表面に形成される。続いて、透明金属膜が蒸着され、共通信号線 42 とコンタクトさ

れるようにパターンニングされカウンタ電極 43 が形成される。

【0054】図面には示されていないが、前記カウンタ電極 43、ゲートバスライン 41a、41b 及び共通信号線 42 を形成するための様々な方法が用いられる。たとえば、第 1 基板 41 上に ITO 膜を形成しパターンニングするカウンタ電極 43 を先ず形成し、その後、カウンタ電極 41 を含む結果的な構造上に MoW 膜を蒸着しパターンニングしてゲートバスライン 41a、41b 及び共通信号線 42 を形成する。

【0055】また、他の例によれば、第 1 基板 40 上に MoW 膜を蒸着しパターンニングしてゲートバスライン 41a、41b と共通信号線 42 を先ず形成し、その後、ゲートバスライン 41a、41b と共通信号線 42 を含む結果的な構造上に ITO 膜を蒸着しパターンニングしてカウンタ電極 43 を形成する。

【0056】図 11 を参照すれば、ゲート絶縁膜（図示せず）が下部基板 40 の結果物上部に蒸着される。ゲート絶縁膜はシリコン酸化膜、シリコン窒化膜、シリコン酸化膜とシリコン窒化膜との積層膜及び金属酸化膜などが用いられる。

【0057】次に、単結晶シリコン膜、非晶質シリコン膜またはポリシリコン膜中のいずれか一つの膜が蒸着された後、所定部分がパターンニングされ、チャネル層 45 が形成される。次いで、ITO 層が、例えば 400 乃至 1000 Å の厚みに形成された後、フォトリソグラフィ工程により対向電極 43 とオーバーラップするようにパターンニングされ、画素電極 46 が形成される。

【0058】図 12 に示すように、不透明金属膜、例えば Al、Mo、Ti、W、Ta、Cr 及びこれらの組合せから構成された群より選択されたいずれか一つの金属膜が約 4000 乃至 4500 Å の厚みに形成される。次いで、金属膜がフォトリソグラフィ工程により所定部分がパターンニングされ、データバスライン 47a、47b、ドレイン 48 及びソース 49 が形成される。したがって、薄膜トランジスタ 50 が完成される。ここで、対向電極 43 と画素電極 46 は従来より浅い厚みに形成されるため、下部基板 40 に甚だしい段差が発生しない。したがって、別の平坦化工程を行わなくてもよい。

【0059】そして図面には示していないが、第 1 配向膜、即ちプリティルト角が 1° 以下を有する水平配向膜が下部基板 40 の結果物上部にコーティングされる。また、カラーフィルタの形成された第 2 基板、即ち上部基板（図示せず）が準備され、プリティルト角が 1° 以下である第 2 配向膜が形成される。第 1 及び第 2 配向膜はコーティングされた後、予定された方向にラビング処理される。次に、上部基板と下部基板 40 はそれぞれの配向膜が対向するよう、一定のギャップを有し合着される。次いで、上、下部基板の間に液晶が注入されて封入(seal)される。

【0060】このような液晶表示装置は次のとおりに動く。まず、ゲートバスライン 41a が選択されなければ、画素電極 46b には信号が印加されなく、対向電極 43 と画素電極 46b との間に電界が形成されない。これにより、偏光子 58 の底部から入射される光は、偏光子 58、検光子 59 及び液晶分子の配置によって光が遮断される。

【0061】図 8 と図 13 を参照すれば、偏光子 58 の偏光軸 58a と検光子 59 の吸収軸 59a が互いに直交し、偏光子 58 の偏光軸 58a と第 1 配向膜 55 のラビング軸 55a が互いに平行し、第 2 配向膜 56 のラビング軸 56a が第 1 配向膜 55 のラビング軸 55a と約 180° の角をなすと、電界の印加前に、前記液晶分子等 57a は第 1 配向膜 55 と、第 2 配向膜 56 のラビング軸 55a、55b に平行に配列される。前記偏光子 58 を通過した入射光は線偏光される。線偏光された光は、液晶分子層を通過する間に、それらの振動方向が液晶分子等の長軸と一致するため、それらの偏光状態は変化されない。よく知られているように、線偏光された光の振動方向が液晶分子等の光軸と一致すると、偏光状態は変化されない。それで、そのような結果は液晶分子等の長軸が液晶分子等の光軸と一致するというを示す。液晶層 57 を通過した光は検光子 59 に入射するが、偏光軸 58a と垂直な吸収軸 59a を有する検光子 59 を通過できなくなつて、画面はダーク状態となる。

【0062】一方、図 9 と図 14 を参照すれば、偏光子 58 の偏光軸 58a と検光子 59 の吸収軸 59a が互いに直交し、偏光子 58 の偏光軸 58a と第 1 配向膜 55 のラビング軸 55a が互いに直交し、第 2 配向膜 56 のラビング軸 56a が第 1 配向膜 55 のラビング軸 55a と約 180° の角をなすと、電界の印加前に、前記液晶分子等 57a は第 1 配向膜 55 と、第 2 配向膜 56 のラビング軸 55a、55b に平行に配列される。前記偏光子 58 を通過した入射光は線偏光される。線偏光された光は、液晶分子層を通過する間に、それらの振動方向が液晶分子等の短軸と一致するため、それらの偏光状態は変化されない。これは液晶分子等の短軸が液晶分子等の光軸と一致するというを示す。液晶層 57 を通過した光は検光子 59 へ入射するが、偏光軸 58a と垂直な吸収軸 59a を有する検光子 59 を通過できなくなつて、画面はダーク状態となる。

【0063】一方、図 5 または図 6 を参照すれば、ゲートバスライン 41a に走査信号が印加され、データバスライン 47a に表示信号が印加されれば、ゲートバスライン 41a とデータバスライン 47a との交差点の付近に形成される薄膜トランジスタ 50 がターンオンされ、画素電極 46 に伝えられる。この時、対向電極 43 には表示信号と所定の電圧差を有する共通信号が続けて印加されている状態であるため、対向電極 43 と画素電極 46 との間に電界が形成される。ここで、実質的に電界が

形成される部分は、対向電極 4 3 のストリップ 4 3 b と画素電極 4 6 のストリップ 4 6 b との間である。

【0064】上記で説明したように、対向電極 4 3 のストリップ 4 3 b 及び画素電極 4 6 のストリップ 4 6 b 間の距離 1 1 1 が従来に比べ非常に狭いため、電界は少数の直線電界 E 1 s と、従来より曲率の大きい多数の放物線電界 E 1 f が発生する。ここで、少数の線形電界 E 1 s は、段差を有するストリップ 4 3 b と隣接したストリップ 4 6 b 間の上部表面の端領域でのみ発生され、多数の放物線電界 E 1 f は、各ストリップ 4 3 b、4 6 b の上部表面の殆どの領域で発生される。その放物線電界 E 1 f は、ストリップ 4 3 b、4 6 b のほぼ全領域で発生されるので、電界の印加の間に、ストリップ 4 3 b、4 6 b 上にある全ての液晶分子等、実質的に液晶層内にあるほぼ全ての液晶分子等が放物線電界の方向にそって配列される。

【0065】これをより詳細に説明すれば、図 1 5 に示すように、カウンタ電極 4 3 のストリップ 4 3 b の幅は、カウンタ電極 4 3 のストリップ 4 3 b と画素電極 4 6 のストリップ 4 6 b 間の距離が、カウンタ電極のストリップ 4 3 b とその右側にある画素電極のストリップ 4 6 b 間で生成された電気力線 e 1 中、最外角電気力線 e 1 - n と放物線電界をなす程に十分に狭くて短いため、電極等のストリップの上部表面の中央部上にある液晶分子等までも電界の影響のため配向される。このような事実は、電極等のストリップ等の幅と、電極等の隣接したストリップ間の距離が広くて長い従来の液晶表示装置とは非常に異なる。

【0066】液晶分子 5 7 a は、偏光軸 5 5 a と 0° よりは大きく、90° より小さい角度差を有する電界に対しその長軸が平行または垂直になるように捻れるため、光が透過するという事実は明らかになる。即ち、配向膜のラビング軸と電界とがなす角 ϕ を考慮して誘電率異方性が陽または陰と選択されたので、液晶表示装置は最大透過率を示す。

【0067】また上記のようにストリップ間の距離 1 1 1 をセルギャップ d 1 1 より小さくすることで、従来より低いしきい電圧を得ることができる。一般に IPS モードの液晶表示装置のしきい電圧は次の式 2 で表れる。

$$V_{th} = \pi l / d (K_2 / \epsilon_0)$$

V_{th} : $\Delta \epsilon$ のしきい電圧 (式 2)

l : 電極間の距離

d : セルギャップ

K_2 : 捻れ弾性係数

ϵ_0 : 誘電率

$\Delta \epsilon$: 誘電率異方性

前記式のように、 l/d が本実施の形態によれば相対的に減少するため、より低いしきい電圧 V_{th} を得ようになる。したがって、低電圧の駆動が可能になる。

【0068】図 1 6 は、対向電極 4 3 のストリップ 4 3 b の幅 P 1 1 と画素電極 4 6 のストリップ 4 6 b の幅 P 1 2 をそれぞれ 3 μm 、対向電極 4 3 のストリップ 4 3 b と画素電極 4 6 のストリップ 4 6 b との距離 1 1 1 を 1 μm 、セルギャップ d 1 1 を 3.9 μm 、プリティルト角を 2°、第 1 配向膜 5 5 のラビング軸 5 5 a と電界 (x 軸) とがなす角を 12°、液晶 5 7 の誘電率異方性 $\Delta \epsilon$ を -4、液晶 5 7 の屈折率異方性 Δn とセルギャップ d とをかけた値を 0.29、光波長 λ を 546 nm、駆動電圧を 6 V としてシミュレーションした結果図面である。

【0069】ここで、参照番号 5 7 a は液晶内の液晶分子を表す。図面のように、ストリップ 4 3 b と 4 6 b との間及びこれら上部で液晶分子が全て捻れるため、全領域で均等な透過率を示す。画素電極 4 6 b に電圧を印加し 31.17 ms 後に飽和し、約 40.31% という高い透過率を示す。これにより、従来のような時間帯と比較し非常に高い透過率を示し、応答速度も大きく改善される。更に、従来より低い駆動電圧を印加しても、より高い透過率を得るので低電圧の駆動が可能である。

【0070】図 1 8 は、対向電極 4 3 のストリップ 4 3 b の幅 P 1 1 と画素電極 4 6 のストリップ 4 6 b の幅 P 1 2 をそれぞれ 4 μm 、対向電極 4 3 のストリップ 4 3 b と画素電極 4 6 のストリップ 4 6 b との距離 L 1 1 を 1 μm 、セルギャップ d を 3.9 μm 、プリティルト角を 2°、第 1 配向膜 5 5 のラビング軸 5 5 a と電界 (x 軸) とがなす角を 12°、液晶 5 7 の誘電率異方性 $\Delta \epsilon$ を -4、液晶 5 7 の屈折率異方性 Δn とセルギャップ d とをかけた値を 0.29、光波長 λ を 546 nm、駆動電圧を 6 V としてシミュレーションした結果図面である。

【0071】図 1 8 もやはり、電極 4 3 b と 4 6 b との間及びこれら上部で液晶分子が全て捻れるため、全領域で均等な透過率を示す。画素電極 4 6 b に電圧を印加し 31.08 ms 後に約 37.10% の比較的高い透過率を示す。これにより、従来のような時間帯と比較し非常に高い透過率を示し、応答速度も大きく改善される。ここで、本実施の形態の応答速度が従来の IPS モードの液晶表示装置より大きく改善されることは、一つ、電極間に発生する電界の直線の長さが従来に比べ大きく短縮され電界の強さが大きくなるからである。二つは、電極間の距離が従来に比べ短くなるので、従来より曲率及び半径の大きい放物線状のフリンジ電界が形成され、上部基板側に位置する液晶分子を効果的に動かすからである。

【0072】上記の二つのシミュレーション結果は、全て従来の IPS モードの液晶表示装置よりは透過率及び応答速度が大きく向上した。とことが、前記二つのシミュレーション結果を比較してみる時、電極の幅が狭いほう (図 1 7) が透過率及び応答速度面でもう少し有利な

ことが知れる。

【0073】図13は画素電極に印加される表示電圧による光の透過率を示すグラフであって、A1は対向電極43のストリップ43bの幅P11が $3\mu\text{m}$ 、画素電極46のストリップ46bの幅P12が $3\mu\text{m}$ 、対向電極43のストリップ43bと画素電極46のストリップ46bとの距離を $1\mu\text{m}$ とした場合であり、A2は対向電極43のストリップ43bの幅P11が $4\mu\text{m}$ 、画素電極46のストリップ46bの幅P12が $3\mu\text{m}$ 、対向電極43のストリップ43bと画素電極46のストリップ46bとの距離を $1\mu\text{m}$ とした場合であり、A3は対向電極43のストリップ43bの幅P11が $4\mu\text{m}$ 、画素電極46のストリップ46bの幅P12が $4\mu\text{m}$ 、対向電極43のストリップ43bと画素電極46のストリップ46bとの距離を $1\mu\text{m}$ とした場合であり、A4は従来のIPSモードの場合であって、画素電極と対向電極の幅を $20\mu\text{m}$ 、画素電極と対向電極との距離を $210\mu\text{m}$ とした場合である。

【0074】上記のA1、A2、A3は全てほぼ同一な電圧(約1.7V)で光が透過し始め、ほぼ似た電圧(約6V)で約4.5%の透過率を示し、飽和する。ところが、A4(従来のIPSモード)は同一電圧下で光の透過率が前記A1、A2、A3より小さく、飽和領域区間が非常に狭く、約4Vで2.2%の低い透過率を示し飽和する。

【0075】(第2の実施の形態)図19及び図22を参照し、ゲートバスライン61a、61b、データバスライン67a、67b及び共通信号線62は実施の形態1と同様に下部基板60上に配置される。ここで、ゲートバスライン61a、61b、共通信号線62、データバスライン67a、67bは実施の形態1のように、比較的伝導特性が優れたAl、Mo、Ti、W、Ta、Cr及びこれらの組合せから構成された群より選択されたいずれか一つの金属で形成される。本実施の形態ではMoW合金膜で形成される。

【0076】対向電極63は下部基板60の単位画素領域にそれぞれ形成される。ここで、対向電極63はゲートバスライン61と同一平面に形成され、共通信号線62とコンタクトされる。対向電極63は透明伝導体、例えばITOからなり、四角板状、より望ましくは単位画素が縮小された形状に形成される。ここで、対向電極63は、ゲートバスライン61a、61b及びデータバスライン47a、47bとそれぞれ所定距離だけ隔たるように配置される。

【0077】第2電極、即ち画素電極66もやはり下部基板60の単位画素領域にそれぞれ形成される。この時、画素電極66は対向電極63と重なるよう、ゲート絶縁膜64上部に形成される。画素電極66は対向電極63のように透明伝導体、例えばITOからなり、ゲートバスライン(x軸方向)61a、61bと平行に配置

されるボディー66aと、ボディー66aから逆y軸方向へ延びストリップ状を有する多数の、例えば七つのストリップ66bとを含む。この時、画素電極66のボディー66aとストリップ66bは全て対向電極63とオーバーラップするため、第1の実施の形態より蓄積キャパシタンスが更に増大する。

【0078】ストリップ66bは一定の幅P22を有し、一定の距離L22を有し配列される。そして、対向電極63が板状となっているので、画素電極66のストリップ66bの間で対向電極63が露呈される。従って、第1の実施の形態のように、第2の実施の形態でも画素電極66のストリップ66bとカウンタ電極63の露出された部分等が互いに交代されると見なすこともできる。この時、画素電極66のストリップ66bは、図20に示すように、その先端がx軸方向と平行な、また異なるボディー66cに連結されることができる。画素電極66のストリップ66bと対向電極63の露出された部分との間には、図19と図20に示したように、平面から見た場合には距離が存在しなく見え、図21に示したように、断面から見た場合にはゲート絶縁膜64の厚みだけの距離が存在する。

【0079】画素電極66のストリップ66b間の距離L22は、単位画素の大きさが $110\times 330\mu\text{m}$ である時、約1乃至 $8\mu\text{m}$ であり、この時、距離L22は単位画素の大きさ及びストリップ66bの数により多少変化がありうる。しかしながら、単位画素領域の面積に係わらず、画素電極66のストリップ66b間の距離L22に対する画素電極66のストリップ66bの幅の比は、約0.2乃至4.0の範囲内に設定されるべきである。そして、セルギャップd22に対する画素電極66のストリップ66b間の距離L22の比は、約0.1乃至5.0の範囲内に設定されるべきである。

【0080】ここで、図21を参照すれば、上記で説明された第1の実施の形態のように、同一の結果が第2の実施の形態でも得られる。画素電極66のストリップ66bのカウンタ電極63に各々信号電圧を印加することにより電気長が発生される。その電気長は、少数の直線電界E2sと、従来より曲率の大きい多数の放物線電界E2fとを含む。ここで、少数の線形電界E2sは、互いに高さの差を有する画素電極66のストリップ66bと前記ストリップ66bに隣接したカウンタ電極63の露出された部分等でのみ発生され、多数の放物線電界E2fは、ストリップ66bと、カウンタ電極63の露出された部分の上部表面等の殆どの領域で発生される。その結果、電界の印加の間に、画素電極66のストリップ66b上にあるほぼ全ての液晶分子等と、カウンタ電極63の露出された部分上にあるほぼ全ての液晶分子等、実質的に液晶層内にあるほぼ全ての液晶分子等が放物線電界の方向にそって配列される。その理由は、その幅P22が従来の液晶表示装置に比し十分に狭いためであ

る。これは、画素電極 66 のストリップ 66b の上部表面とカウンタ電極 63 の露出された部分等の中央部にまで放物線電界 E_{2f} が影響を与えた結果である。

【0081】図 19 と図 20 を参照すれば、薄膜トランジスタ 70 は、第 1 の実施の形態と同じ位置に形成され、ゲートバスライン 61a の上部に形成されるチャンネル層 65 と、チャンネル層 65 の一側とオーバーラップされデータバスライン 67a から伸張されたドレイン電極 68 と、チャンネル層 65 の他側とオーバーラップされ画素電極 66 の所定部分とコンタクトされるソース電極 69 とを含む。

【0082】第 2 の実施の形態において、蓄積キャパシタ C_{st} は、上記したように、画素電極 66 のボディ 66a とカウンタ電極 63 の第 1 重畳領域と、画素電極 66 のストリップ 66b とカウンタ電極 63 の第 2 重畳領域で形成される。従って、総キャパシタは第 1 実施の形態に比し増加することになる。

【0083】図 21 を参照すれば、前記した構造を有する下部基板 60 上には、所定距離 d_{22} をおいて上部基板 72 が配置される。下部基板 60 の内側面と対向する上部基板 72 の内側面上にはカラーフィルタ 56 が形成される。

【0084】第 1 及び第 2 配向膜 75、76 の配向状態、ラビング軸と x 軸とがなす角等は、第 1 の実施の形態と同様である。また、偏光子 78 及び検光子 79 の配置状態も第 1 の実施の形態と同様である。

【0085】液晶 77 は、第 1 及び第 2 配向膜 75、76 間に介在される。この時、液晶 77 は、第 1 の実施の形態と同一にネマティック液晶を利用し、ツイスト可能な特性を持つ。また、前記で言及されたように、最大透過率条件を満たすように、ラビング軸と x 方向との角を考慮して誘電率異方性 $\Delta\epsilon$ を選択する。液晶 97 内分子の屈折率異方性 Δn とセルギャップ d_{11} との積が $0.2\mu m$ 乃至 $0.6\mu m$ となるように設定する。

【0086】本発明の第 2 の実施の形態の製造方法は、第 1 の実施の形態と同様であるので、その説明を省略する。このような第 2 の実施の形態にかかる液晶表示装置の動作を図 19、20 及び 21 を参照しながら説明する。まず、カウンタ電極 63 と画素電極 66 間に電界が形成されない場合、第 1 の実施の形態と同じ原理により入射される光が遮断される。

【0087】一方、カウンタ電極 63 及び画素電極 66 に所定の電圧が印加されると、カウンタ電極 63 と画素電極 66 のストリップ 66b 間には間隔が存在しないので、電界は少数の直線電界 E_{2s} と、従来より曲率が大きい多数の放物線電界 E_{2f} が発生される。ここで、放物線電界 E_{2f} は第 1 の実施の形態で説明されたように、電極等 63b、66b の上部に存在する液晶分子等が殆ど動作されるので、入射光は液晶層と検光子等を透過してホワイト状態となる。

【0088】図 22 は画素電極 66 のストリップ 66b の幅 P_{22} をそれぞれ $3\mu m$ 、画素電極 66 のストリップ 66b 間の距離 L_{22} を $5\mu m$ 、セルギャップ d を $3.9\mu m$ 、プリティルト角を 2° 、第 1 配向膜 75 のラビング軸と電界 (x 軸) とがなす角を 12° 、液晶 77 の誘電率異方性 $\Delta\epsilon$ を -4 、液晶 77 の屈折率異方性 Δn とセルギャップ d とをかけた値を 0.29 、光波長 λ を $546nm$ 、駆動電圧を $6.3V$ としてシミュレーションした結果図面である。図面のように、電極 63 と 66b との間及びこれら上部で液晶分子が全て捻れるため、全領域で均等な透過率を示す。画素電極 46b に電圧を印加し $40.03ms$ 後に飽和し、約 41.88% という高い透過率を示す。これにより、従来のような時間帯と比較して非常に高い透過率を示し、応答速度も大きく改善される。

【0089】図 23 は画素電極 66 のストリップ 66b の幅 P_{22} をそれぞれ $3\mu m$ 、画素電極 66 のストリップ 66b 間の幅を $3\mu m$ 、セルギャップ d を $3.9\mu m$ 、プリティルト角を 2° 、第 1 配向膜 75 のラビング軸と電界 (x 軸) とがなす角を 12° 、液晶 77 の誘電率異方性 $\Delta\epsilon$ を -4 、液晶 77 の屈折率異方性 Δn とセルギャップ d とをかけた値を 0.28 、光波長 λ を $546nm$ 、駆動電圧を $6V$ としてシミュレーションした結果図面である。図面のように、電極 63 と 66b との間及びこれら上部で液晶分子が全て捻れるため、全領域で均等な透過率を示す。画素電極 46b に電圧を印加し $41.15ms$ 後に飽和し、約 41.32% という高い透過率を示す。これにより、従来のような時間帯と比較して非常に高い透過率を示し、応答速度も大きく改善される。

【0090】〈第 3 の実施の形態〉図 24 及び図 25 を参考すると、ゲートバスライン 81a、81b、データバスライン 87a、87b 及び共通信号線 82 は第 1 の実施の形態と同様に第 1 基板、即ち、下部基板 80 上の内側面に配置される。本実施の形態の液晶表示装置における単位画素領域等は、その各々が一對のゲートバスライン 81a、81b と一對のデータバスライン 87a、87b によって境界される領域と定義される。ここで、ゲートバスライン 81a、81b、共通信号線 82、データバスライン 87a、87b は、第 1 の実施の形態のように、比較的電伝特性が優れた Al、Mo、Ti、W、Ta、Cr 及びその組み合わせで構成されたグループのいずれか一つの金属膜または二つ以上の合金膜で形成される。本実施の形態では MoW 合金膜で形成される。

【0091】第 1 電極、即ち対向電極 83 は下部基板 80 の内側面上の単位画素空間にそれぞれ形成される。ここで、対向電極 83 はゲートバスライン 81 と同一表面、すなわち、下部基板 80 の表面上に形成され、共通信号線 82 とはコンタクトされるように形成される。対

向電極 83 は透明電伝物質、例えば、ITO(indium tin oxide)物質で形成される。対向電極 83 は、ゲートバスライン 81a、81b の配列方向、すなわち、x 方向と平行しながら共通信号線 82 とコンタクトされるボディー部分 83a と、ボディー部分 83a から逆 y 軸方向に延長される多数のストリップ 83b とを含む。本第 3 の実施の形態で使われた多数のストリップ 83b は 8 個である。より具体的には、対向電極 83 はストリップの一段等が前記ボディー部分 83a により閉められ他段等が開けているコーム構造を持つ。ここで、個々のストリップ 83b は、一定の幅を P31 を持ち、隣接したストリップとの間に一定の距離 L31 を持ちながら配列されている。個々のストリップ 83b の幅は以後に形成される画素電極の幅及び画素電極間の距離を考慮して決定されるが、その上部に位置する液晶分子等を、電界の印加時、十分に動作させることができる程度にできるだけ従来の対向電極に比し狭い幅を持つように形成される。

【0092】第 2 電極、即ち画素電極 86 やはり下部基板 80 の内側面上の単位画素空間に各々形成される。この時、画素電極 86 は対向電極 83 と重なるように、ゲート絶縁膜 84 の上部に形成される。画素電極 86 は対向電極 83 のように透明電伝物質、たとえば、ITO 物質に形成され、ゲートバスライン 81a、81b:x 方向と平行に配置されるボディー 86a と、ボディー 86a から逆 y 方向に延長されストリップ形態を持つ多数、たとえば、7 個のストリップ 86b とを含む。この時、ストリップ 86b は、対向電極 83 のストリップ 83b 間の空間に位置する。即ち、画素電極 86 のストリップ 86b の幅 P32 は対向電極 83 のストリップ 83b 間の距離 L31 と同様であり、ストリップ 86b 間の距離 L32 は対向電極 83 のストリップの幅 83b と同様であるので、ストリップ 83b とストリップ 86b との間には間隔が存在しない。従って、第 3 の実施の形態と第 2 の実施の形態の単位画素構造は、各々図 24 と図 19 に示したように、平面図としては互いに同一に見える。

【0093】ここで、対向電極 83 のストリップ 83b の幅 P31 と画素電極 86 のストリップ 86b の幅 P32 は単位画素サイズが $110\mu\text{m} \times 330\mu\text{m}$ であり、ストリップとストリップの個数が 8 個、7 個である場合、それぞれ $2\mu\text{m}$ 乃至 $8\mu\text{m}$ 程度となるように形成されることが望ましく、画素電極 86 のストリップ 86b 間の距離 L32 は $1\mu\text{m}$ 乃至 $8\mu\text{m}$ 程度に形成される。この時、幅 P31、P32 は単位画素サイズ、ストリップ 83b 及びストリップ 86b の個数によって多少変化されることもある。この時、対向電極 83 のストリップ 83b と画素電極 86 のストリップ 86b の幅 P31、P32 はそれら両側端に発生される放物線フィールドがその中央まで影響を与えられるだけの幅を持つように設計されるべきである。

【0094】また、画素電極 86 のストリップ 86b と

対向電極 83 のストリップ 83b 間には、平面で見た場合、まるで距離が存在しないように見え、断面状態で見た場合、ゲート絶縁膜 84 厚さだけの距離が存在する。対向電極 83 のストリップ 83b と画素電極 86 のストリップ 86b 等は、図 30 に示されたように、その終段がボディー 83a とボディー 86c により各々括られていることもある。又、図面には示されないが、択一的に対向電極 83 のストリップ 83b のみが括られていることもあり、又は画素電極 86 のストリップ 86b のみが括られていることもある。また、画素電極 46 のストリップ 46b 等はボディー 86c のみにより括られており、ボディー 86a が除去される形態にも変形できる。

【0095】スイッチング素子である薄膜トランジスタ 90 は、第 1 の実施の形態と同じ位置に形成され、ゲートバスライン 81a の上部に形成されるチャンネル層 85 と、チャンネル層 85 の一側とオーバーラップされデータバスライン 87a から伸張されたドレイン電極 88 と、チャンネル層 85 の他側とオーバーラップされ画素電極 86 の所定部分とコンタクトされるソース電極 89 とを含む。蓄積キャパシタ Cst は、上記で言及したように、対向電極 83 のボディー部分 83a と画素電極 86 のボディー 86a 間で発生される。

【0096】図 26 に示したように、前記した構造を持つ下部基板 80 上には、所定距離 d33 をおいて上部基板 92 が配置される。上部基板 92 の下部基板 80 の対向面にはカラーフィルタ 96 が形成される。

【0097】第 1 及び第 2 配向膜 95、96 の配向状態、ラビング軸と x 軸がなす角は第 1 の実施の形態と同様である。また、偏光子 98 及び検光子 99 の配置状態も第 1 の実施の形態と同様である液晶 97 は、第 1 及び第 2 配向膜 95、96 間に介在される。この時、液晶 97 は、第 1 の実施の形態と同一にネマティック液晶を利用し、ツイスト特性を持つ。また、前記で言及されたように、最大透過率条件を満たすように、ラビング軸と x 方向との角を考慮して誘電率異方性 $\Delta\epsilon$ を選択する。液晶 97 内分子の屈折率異方性 Δn はセルギャップ d33 との積が $0.2\mu\text{m}$ 乃至 $0.6\mu\text{m}$ となるように設定する。

【0098】本発明の第 3 の実施の形態の製造方法は、第 1 の実施の形態と同様である。このような第 3 の実施の形態にかかる液晶表示装置は、次のような動作を行う。まず、対向電極 83 と画素電極 86 間に電界が形成されない場合、第 1 の実施の形態と同じ原理により入射される光が遮断される。

【0099】一方、対向電極 83 及び画素電極 86 に所定の電圧が印加されると、対向電極 83 のストリップ 83b と画素電極 86 のストリップ 86b 間に距離が存在しないので、電界は少数の直線電界 E_{3s} と、従来より曲率が大い多数の放物線の形態のフリンジ電界 E_{3f} が発生される。ここで、フリンジ電界 E_{3f} は、第 1 の

実施の形態で説明されたように、電極等 8 3 b、8 6 b の上部に存在する液晶分子等が殆ど動作され光が透過される。

【0 1 0 0】図 2 7 は、対向電極 8 3 のストリップ 8 3 b の幅 P 3 1 と画素電極 8 6 のストリップ 8 6 b の幅 P 3 2 を各々 $4 \mu\text{m}$ 、セルギャップ d を $3.9 \mu\text{m}$ 、プレティルト角を 1° 、第 1 配向膜 9 5 のラビング軸と電界 x 軸がなす角を 15° 、液晶 9 7 の誘電率異方性 $\Delta\epsilon$ を -3.4 、液晶 9 7 の屈折率異方性 Δn とセルギャップ d 間の積を 0.25 、光の波長 λ を 546nm 、駆動電圧を 6V としてシミュレーションした結果の図面である。

【0 1 0 1】図面のように、ストリップ等 8 3 b、8 6 b 間およびそれら上部で液晶分子等が全部整列されるので、全領域にかけて均一な透過率を見せる。画素電極 8 6 b に電圧を印加して 30.01ms 後に約 43% という高い透過率を見せる。これにより、従来のような時間帯と比較して非常に高い透過率を見せ、応答速度も大きく改善される。

【0 1 0 2】図 2 9 は、第 1 の実施の形態—第 3 の実施の形態において、視野角による等コントラスト比曲線 (iso-contrast curve) を示す図である。図面のように、 $4/4$ 分面の縁部を除き、画面の全領域が良好な画質程度と言われるコントラスト比 10 以上に示される。したがって、従来の TN モードの視野角による等コントラスト比曲線 (図 3 0 参照) を比較してみる時、コントラスト比が 10 以上である領域はるかに広いことが知れる。

【0 1 0 3】図 3 1 は、第 1 の実施の形態—第 3 の実施の形態において、視野角による明るさ (brightness) を示す図である。図面のように、画面の大部分の領域で 10% 以上の均一な明るさを示すため、従来の TN モードで発生するイクセシブホワイト (excessive white: 180° 方位角から見る時光が極めて多量に透過する現象) 及びイクセシブブラック (excessive black: 0° 方位角から見る時光が極めて少量に透過する現象) が発生しない。

【0 1 0 4】図 3 2 は画素電極に印加される表示電圧による透過度を示すグラフであって、a 1 は本実施の形態と同一の構造を有し液晶の屈折率異方性 Δn が 0.1 である場合、a 2 は本実施の形態と同一の構造を有し液晶の屈折率異方性 Δn が 0.1 である場合、a 3 は一般的な IPS モードの構造を有し液晶の屈折率異方性 Δn が 0.08 である場合である。図面のように、一般的な IPS モードの液晶表示装置より、本実施の形態による液晶表示装置の透過度をはるかに優れている。また、a 1 と a 2 を比較してみる場合には、液晶の屈折率異方性 Δn の大きい方が透過度面では有利である。しかし、屈折率異方性 Δn があまり大きい液晶を使用すれば、透過度面では有利だという長所はあるが、色つき (color shift) 現象が発生できるという短所があって、これを適切に調節し使用するべきである。

【0 1 0 5】また、本発明は上術した実施の形態にのみ限られない。例えば、画素電極の幅が対向電極間の距離より大きく形成され、画素電極とカウンタ電極の端部の一部とが互いに重なっても同じ効果を得ることができる。

05 【0 1 0 6】なお、本発明の請求範囲は上述した内容に限らず、本発明の原理と精神に反しない範囲内において、前記の請求範囲はこの発明に内在している特性である新規な全てのことを含み、合わせて、この発明の属する技術分野で通常の知識を有した人により均等に処理されるあらゆる特徴を含む。

10 【0 1 0 7】

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によれば、次のような効果がある。

(1) 対向電極と画素電極が透明な物質から形成され、電極間の距離は多数のフリンジ電界が発生できるようにセルギャップより小さく形成し、駆動電極の幅はその両側に発生するフリンジ電界で液晶分子が全て動けるだけ十分に狭く形成することにより、電極上部に存在する液晶分子を全て動かす。したがって、従来の IPS モードの液晶表示装置に比べ透過率が大きく改善される。

20 【0 1 0 8】(2) 対向電極と画素電極を透明な物質から形成することにより、開口率が改善される。

【0 1 0 9】(3) 対向電極と画素電極との距離が微細なので、曲率の大きいフリンジ電界が発生し、上部基板側にある液晶分子を効果的に動かし、電極間の距離が短くて電界の強さが増大し、応答速度が大きく改善される。

25 【0 1 1 0】(4) 電極間の距離がセルギャップより小さいため、従来の IPS モードの液晶表示装置 (電極間の距離がセルギャップより大きい) よりしきい電圧を低くすることができる。したがって、低電圧の駆動が可能である。

【0 1 1 1】(5) 従来の TN モードの液晶表示装置より広視野角を得ることができる。

35 【0 1 1 2】また、製造方法面からみれば、対向電極と画素電極との段差を小さくすることができて、別の平坦化工程が必要なく、容易にラビング工程を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】従来の IPS モードの液晶表示装置の単位画素を示す平面図である。

【図 2】図 1 を $202-202'$ 線で切断して示す断面図である。

【図 3】従来の IPS モードの液晶表示装置で電圧の印加時に液晶分子の配列状態をシミュレーションした結果を示す図である。

45 【図 4】本発明の原理を説明するための液晶表示装置の断面図である。

【図 5】本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の単位画素とその周辺部を示す平面図である。

50 【図 6】本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置

の単位画素の変形例を示す平面図である。

【図 7】図 5 を 206-206' 線で切断して示す断面図である。

【図 8】本発明の第 1 の実施の形態による配向膜、偏光子及び検光子の配置状態を示す図である。

【図 9】本発明の第 1 の実施の形態による配向膜、偏光子及び検光子の配置状態を示す図である。

【図 10】本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の製造方法を説明するための各工程における平面図である。

【図 11】本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の製造方法を説明するための各工程における平面図である。

【図 12】本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の製造方法を説明するための各工程における平面図である。

【図 13】本発明の第 1 の実施の形態による配向膜、偏光子及び検光子の配置状態を示す図である。

【図 14】本発明の第 1 の実施の形態による配向膜、偏光子及び検光子の配置状態を示す図である。

【図 15】本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置でストリップ間に発生された電気力線の分布を示す図である。

【図 16】本発明の第 1 の実施の形態による電圧の印加後に時間の経過による透過率の変化を示したシミュレーションした結果を示すグラフである。

【図 17】本発明の第 1 の実施の形態による電圧の印加後に時間の経過による透過率の変化を示したシミュレーションした結果を示すグラフである。

【図 18】本発明の第 1 の実施の形態による表示電圧と光透過度との関係を示すグラフである。

【図 19】本発明の第 2 の実施の形態による液晶表示装置の単位画素とその周辺部を示す平面図である。

【図 20】本発明の第 2 の実施の形態による液晶表示装置の単位画素の変形例を示す平面図である。

【図 21】図 19 を 215-215' 線で切断して示す断面図である。

【図 22】本発明の第 2 の実施の形態による電圧の印加時に液晶分子の配列状態をシミュレーションした結果を示すグラフである。

【図 23】本発明の第 2 の実施の形態による電圧の印加時に液晶分子の配列状態をシミュレーションした結果を示すグラフである。

【図 24】本発明の第 3 の実施の形態による液晶表示装置で画素電極とその周辺部を示す平面図である。

【図 25】本発明の第 3 実施の形態による液晶表示装置

で画素電極とその周辺部を示す平面図である。

【図 26】図 24 と図 25 の 219-219' 線に沿って切断して示す断面図である。

【図 27】本発明の第 3 の実施の形態による電圧印加時液晶分子の配列状態をシミュレーションした結果を示すグラフである。

【図 28】本発明の第 1 の実施の形態-第 3 の実施の形態による液晶表示装置の等コントラスト比曲線を示す図である。

【図 29】従来の TN モードの液晶表示装置の視野角依存度による等コントラスト比曲線を示す図である。

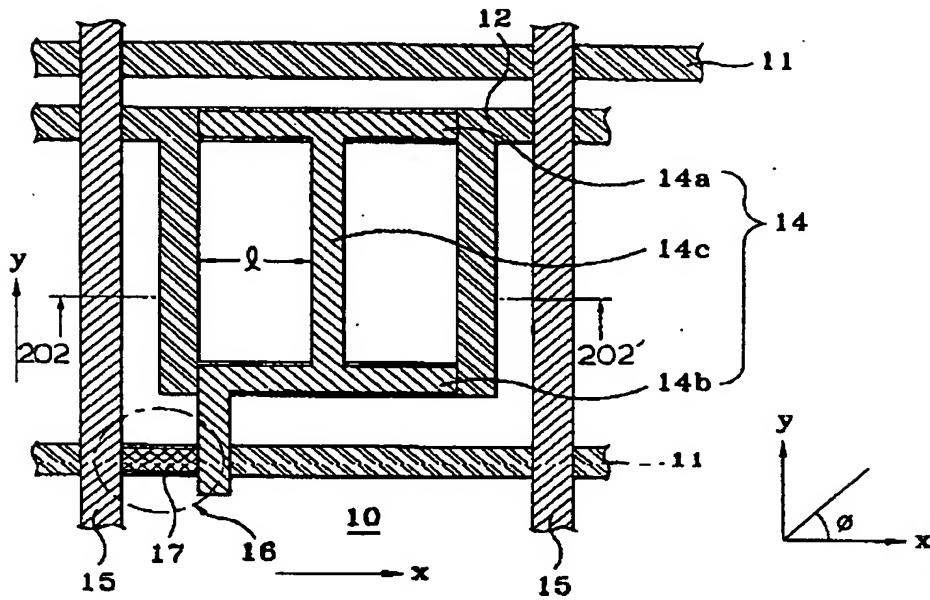
【図 30】本発明の第 1 の実施の形態-第 3 の実施の形態による液晶表示装置の視野角依存度による輝度を示す図である。

【図 31】本発明の第 1 の実施の形態-第 3 の実施の形態による $\Delta n d$ を変化させる時、駆動電圧による透過度の変化を示すグラフである。

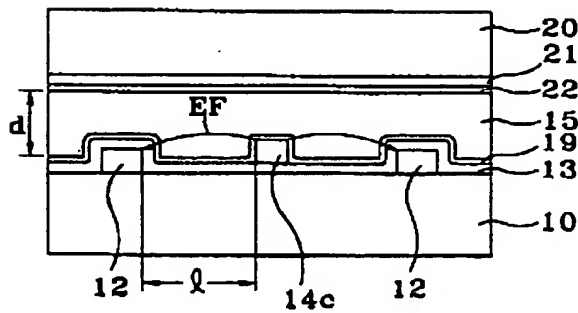
【符号の説明】

30, 40, 60, 80	第 1 基板 (下部基板)
43, 63, 83	第 1 電極 (カウンタ電極)
46, 66, 86	第 2 電極 (画素電極)
36, 52, 72, 92	第 2 基板 (上部基板)
41a, 41b, 61a, 61b, 81a, 81b	ゲートバスライン
42, 62, 82	共通信号線
44, 64, 84	ゲート絶縁膜
45, 65, 85	チャネル層
47a, 67a, 81a	データバスライン
48, 68, 88	ドレイン電極
49, 69, 89	ソース電極
50, 70, 90	薄膜トランジスタ
54, 74, 94	カラーフィルタ
55, 75, 95	第 1 配向膜
55a	第 1 配向膜のラビング軸
56, 76, 96	第 2 配向膜
56a	第 2 配向膜のラビング軸
57, 77, 97	液晶
58, 78	偏光子
58a	偏光軸
59, 79	検光子
59a	吸収軸
43a, 46a, 63a, 66a, 83a, 86a	ボディー
43b, 46b, 63b, 66b, 83b	
45	ストリップ

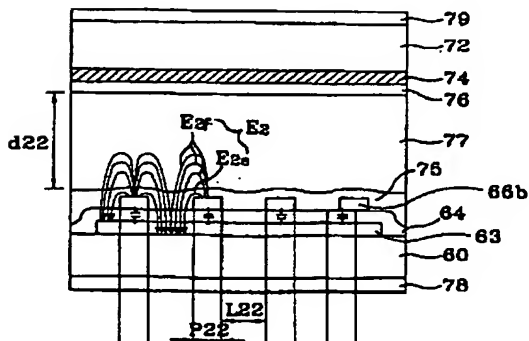
【図1】



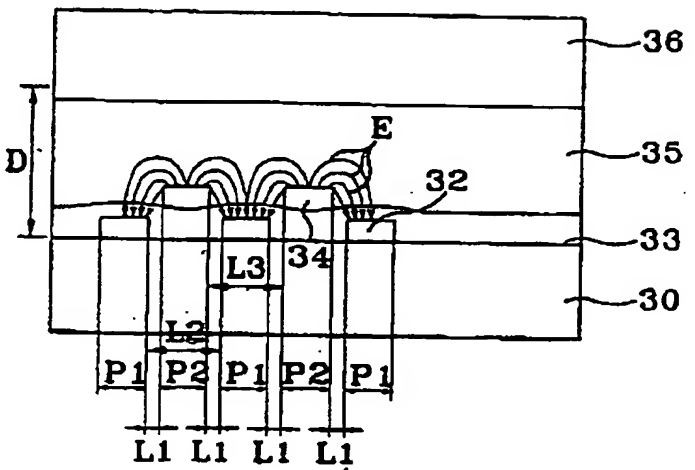
【図2】



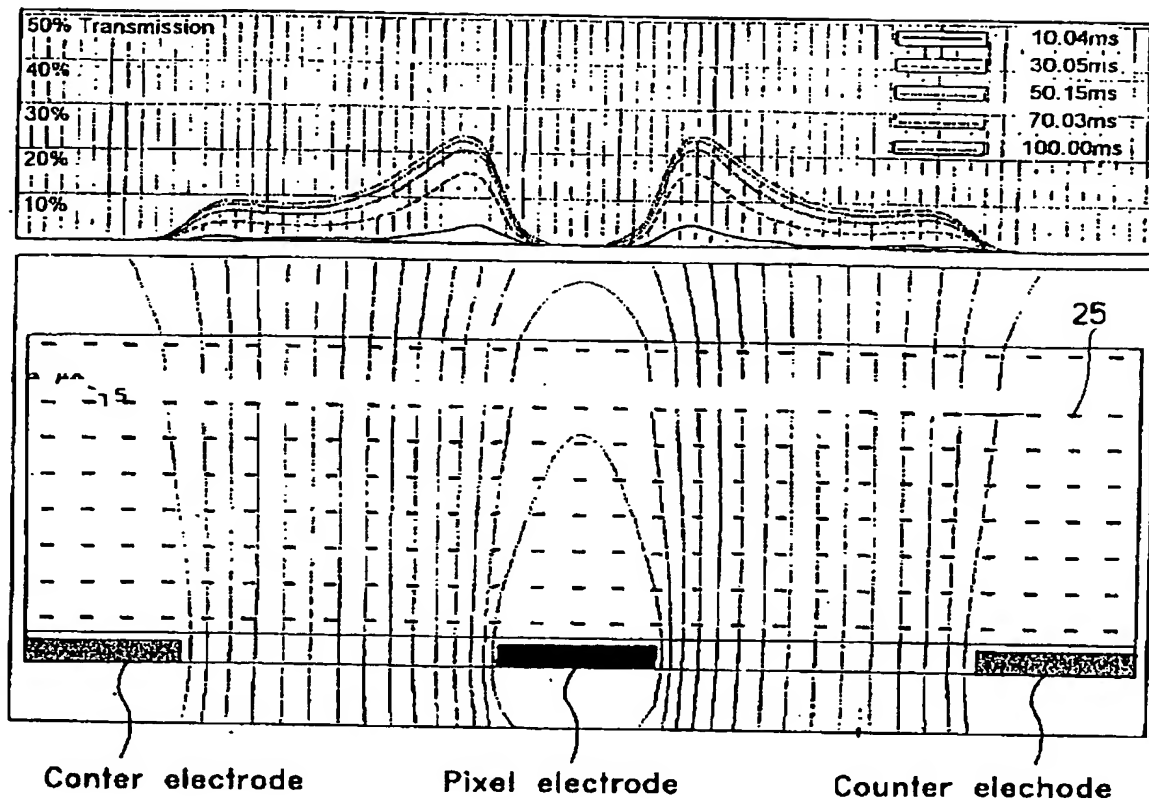
【図21】



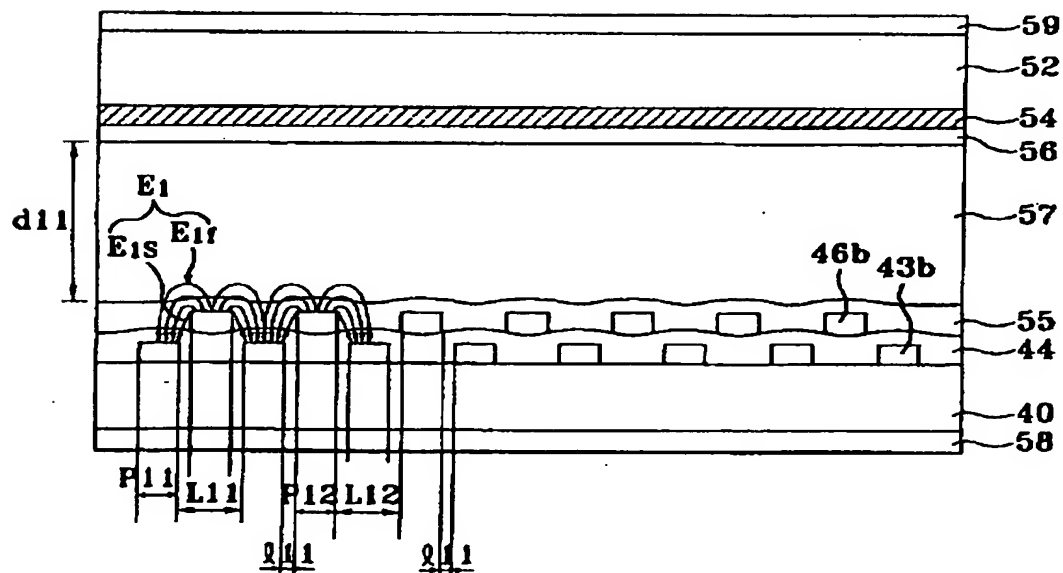
【図4】



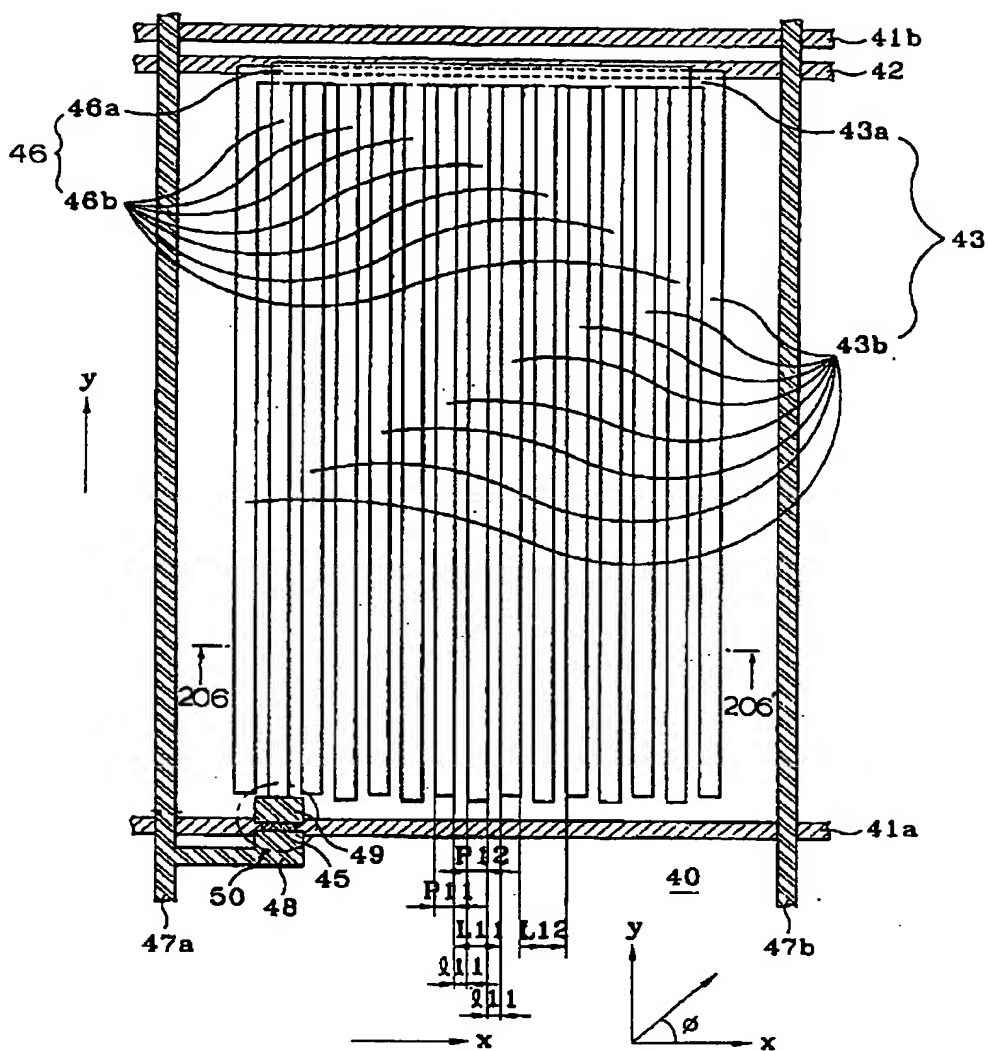
【図3】



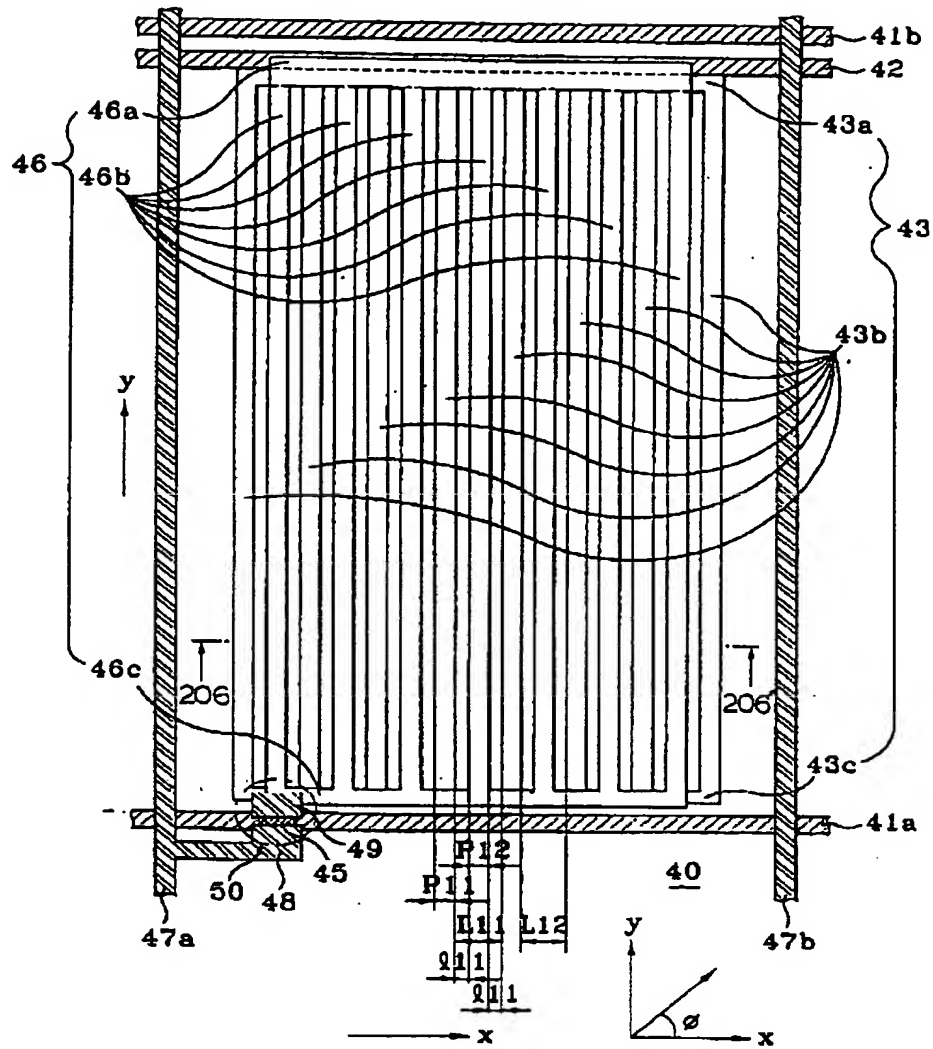
【図7】



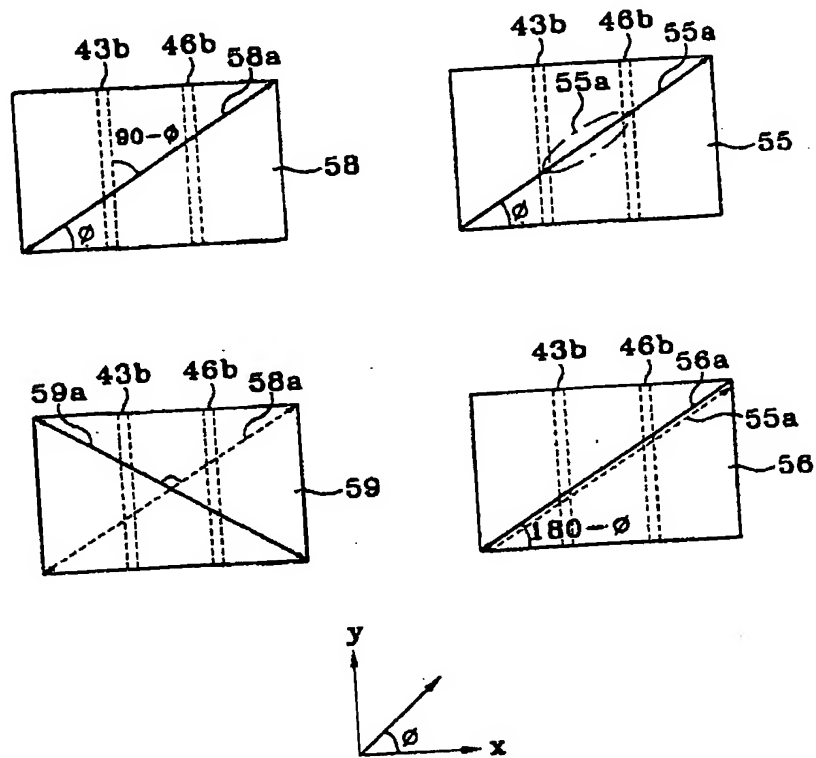
【図5】



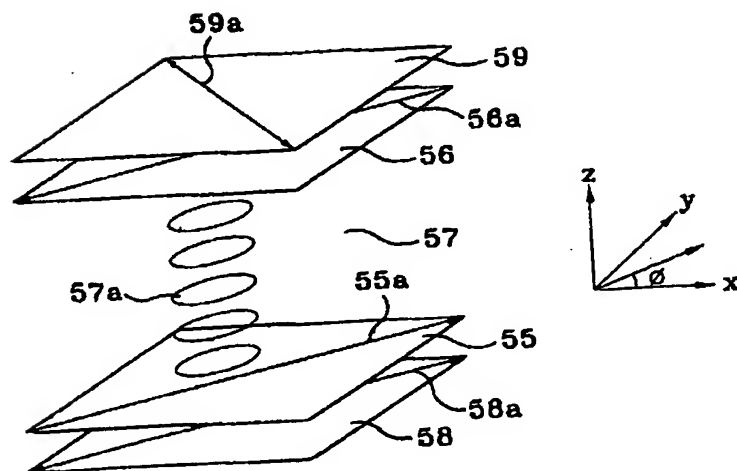
【図6】



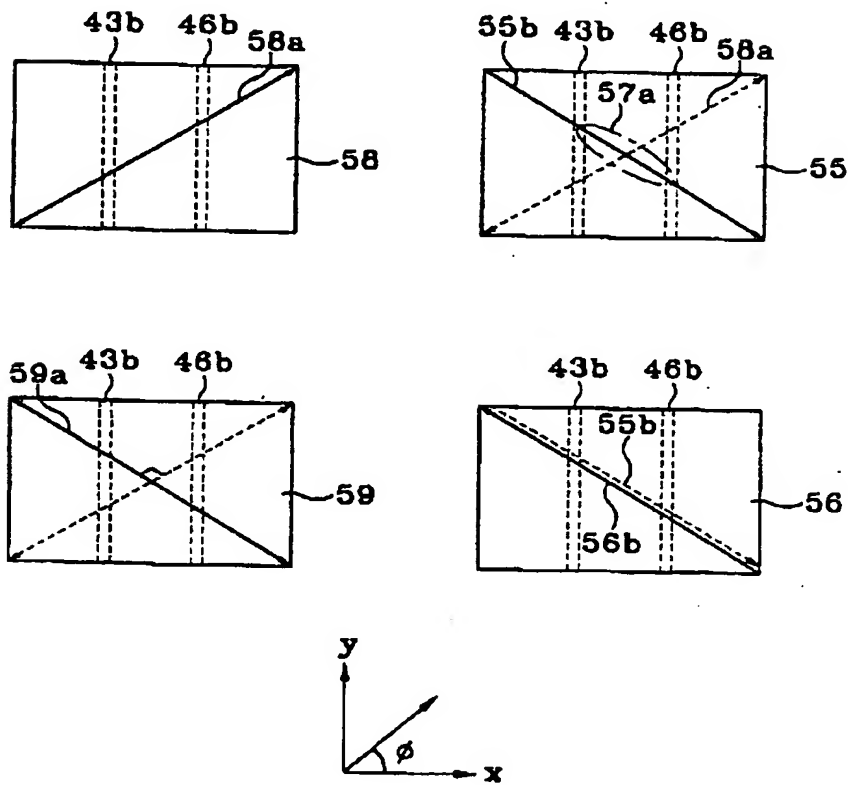
【図8】



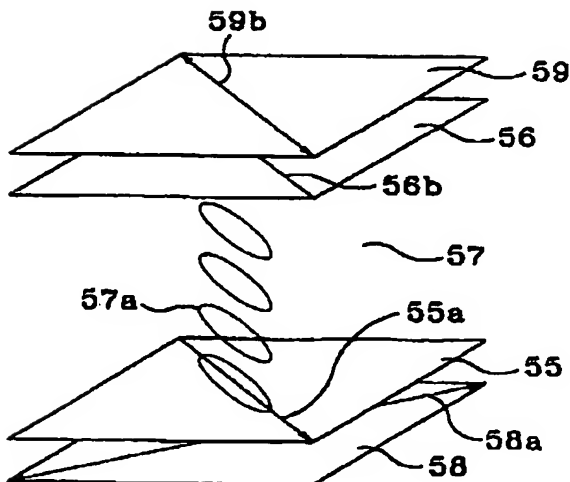
【図13】



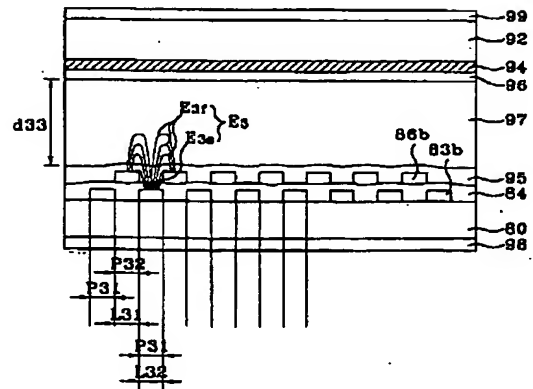
【図9】



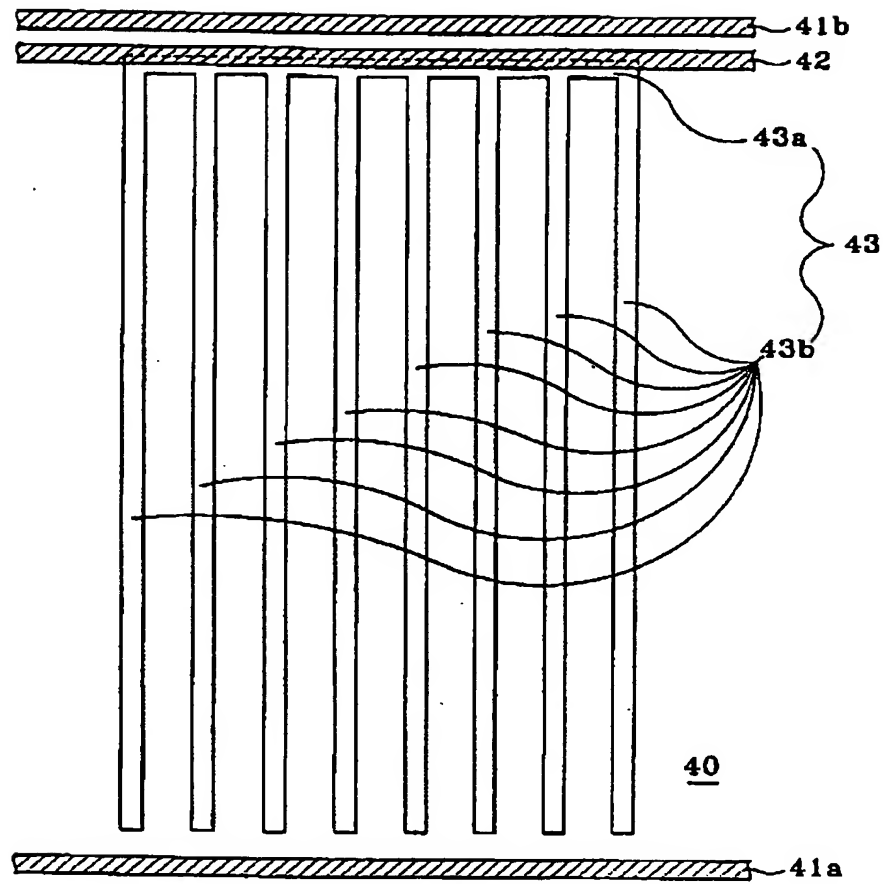
【図14】



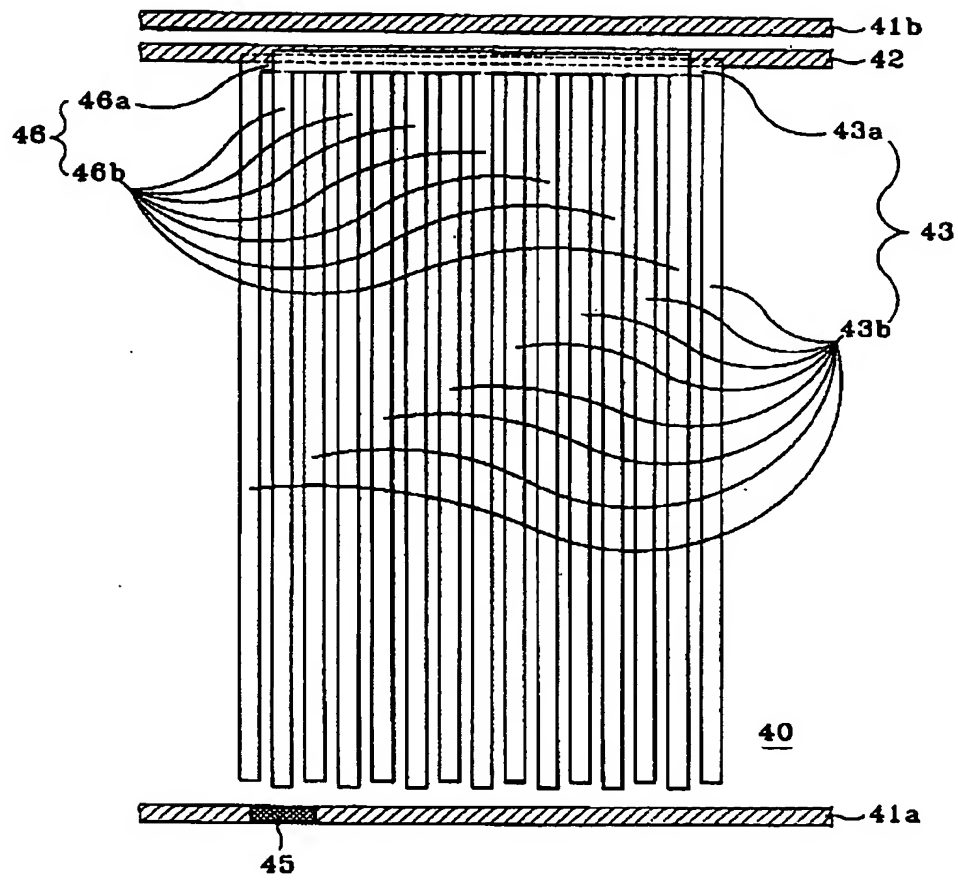
【図26】



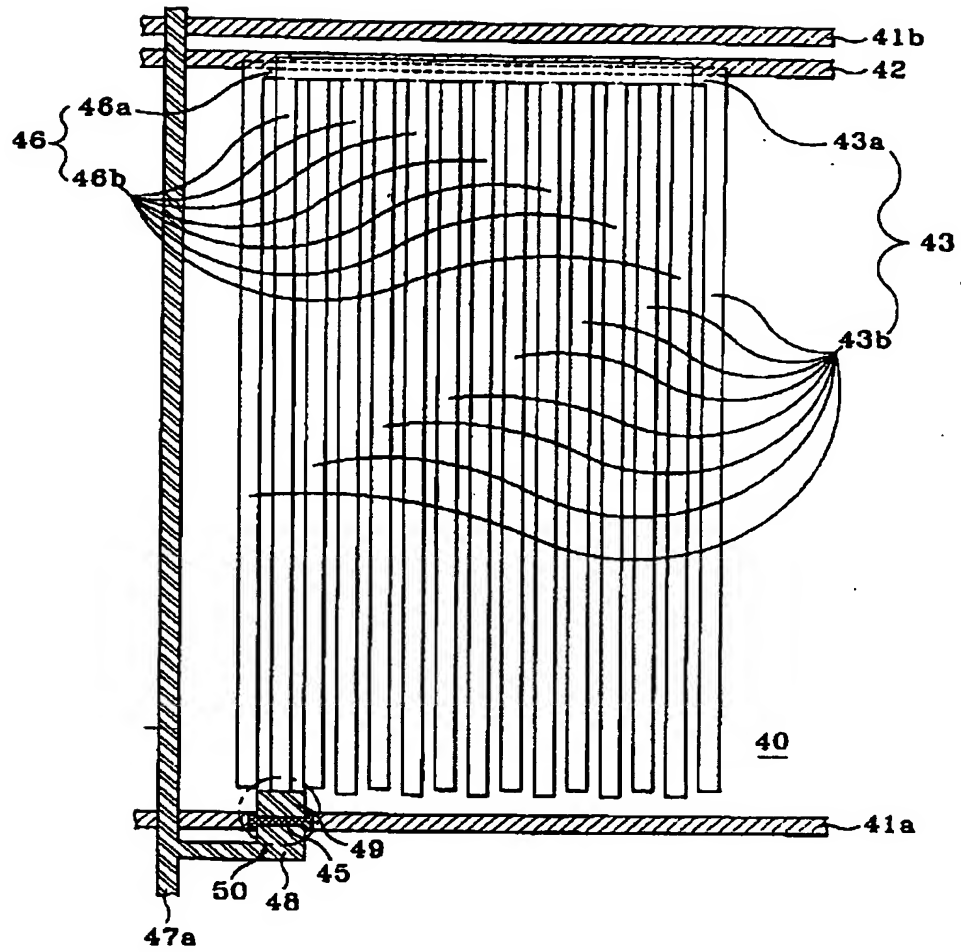
【図10】



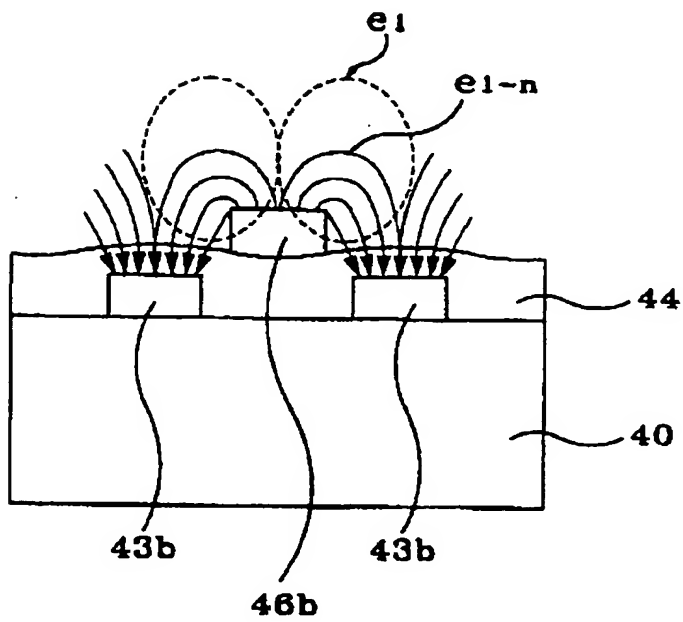
【図 11】



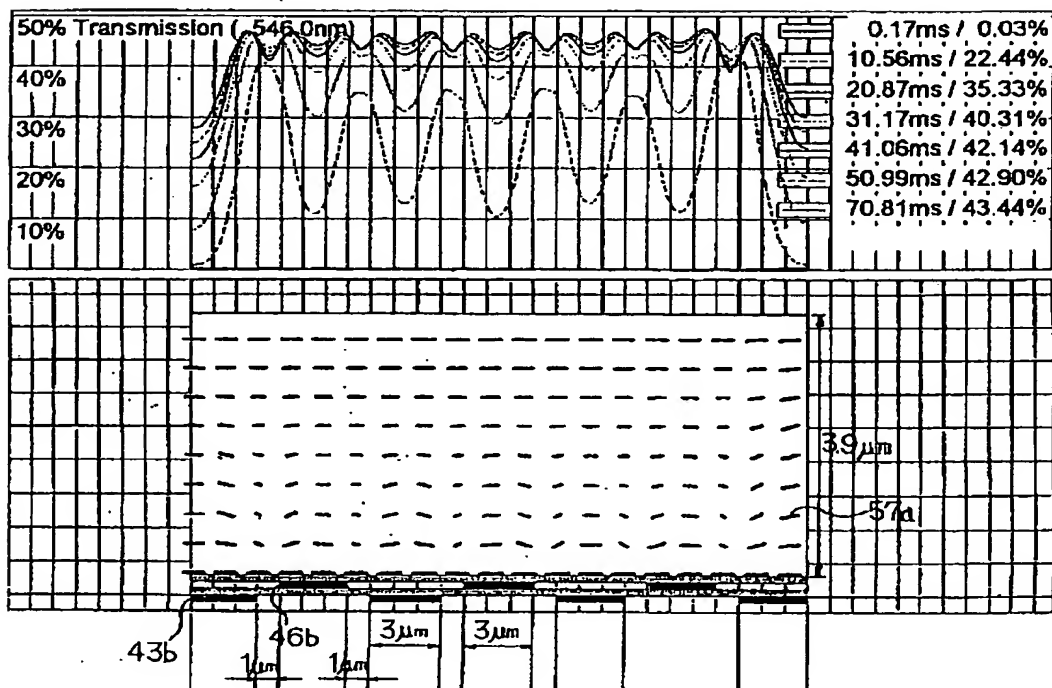
【図12】



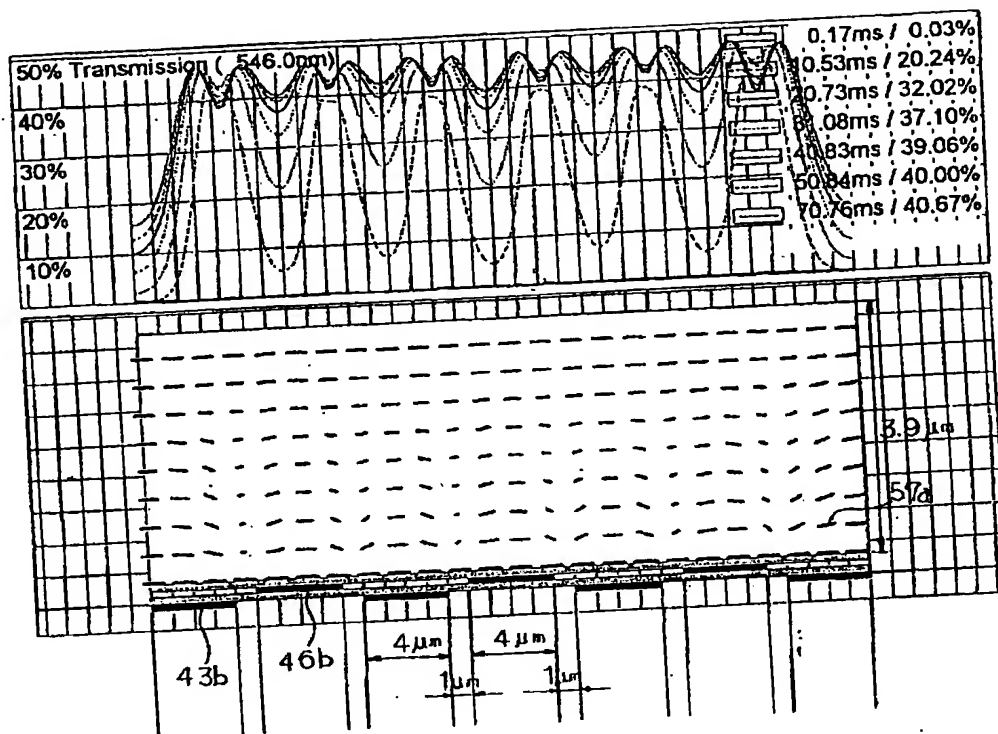
【図15】



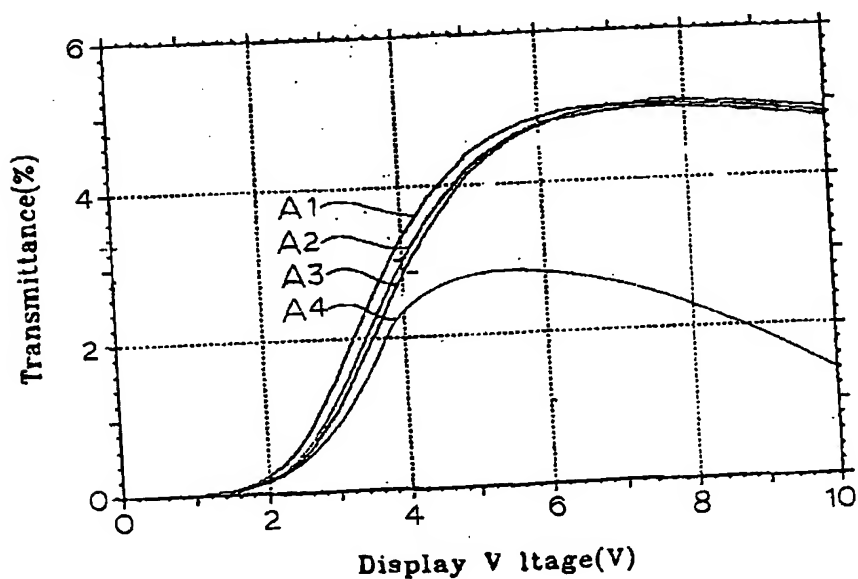
【図16】



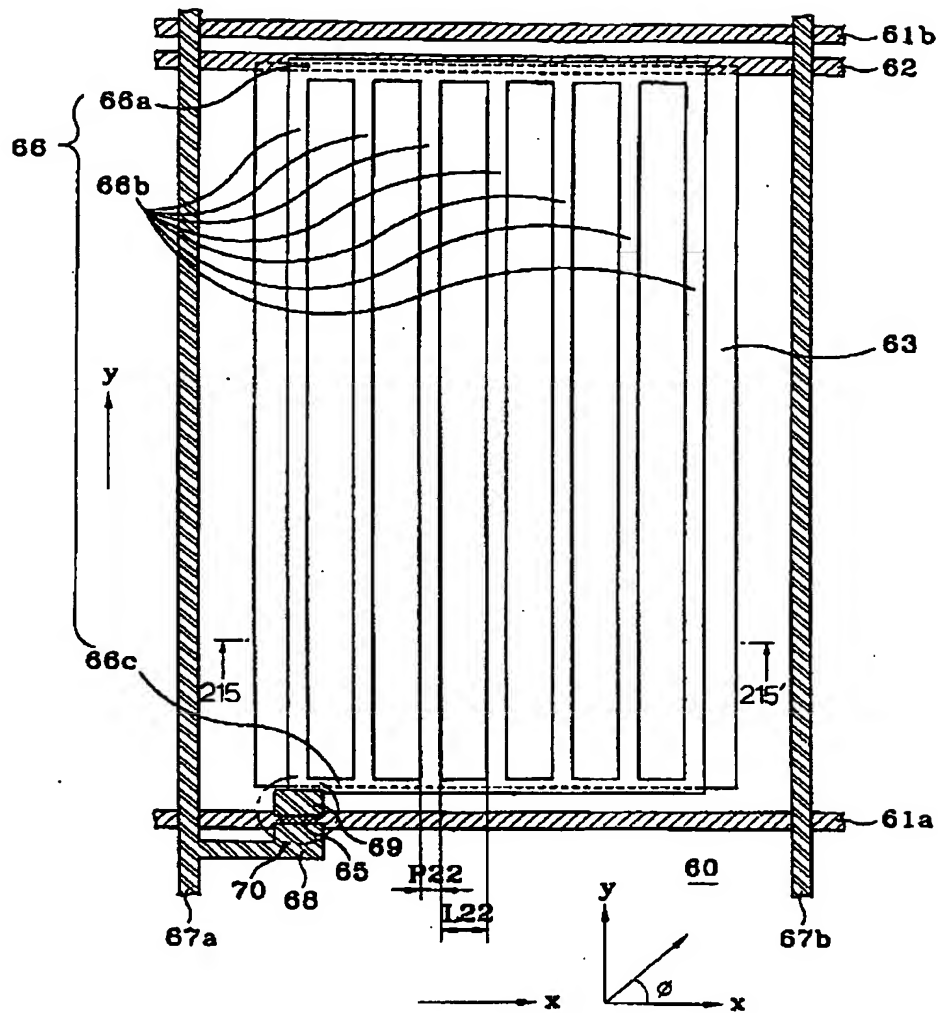
【図 17】



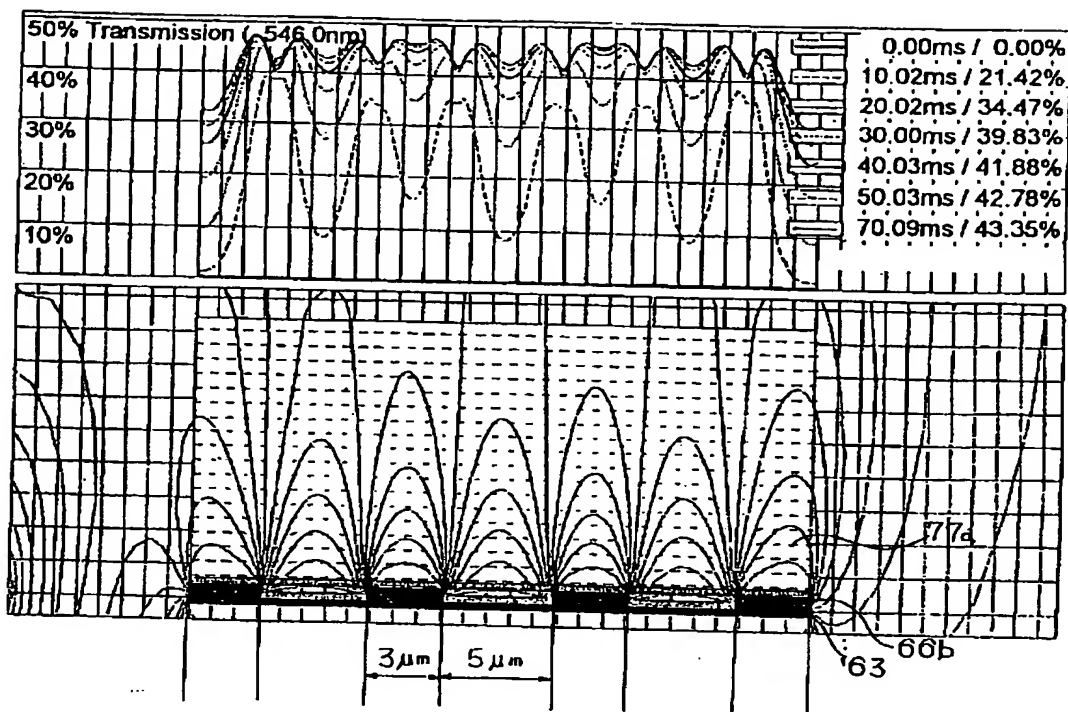
【図 18】



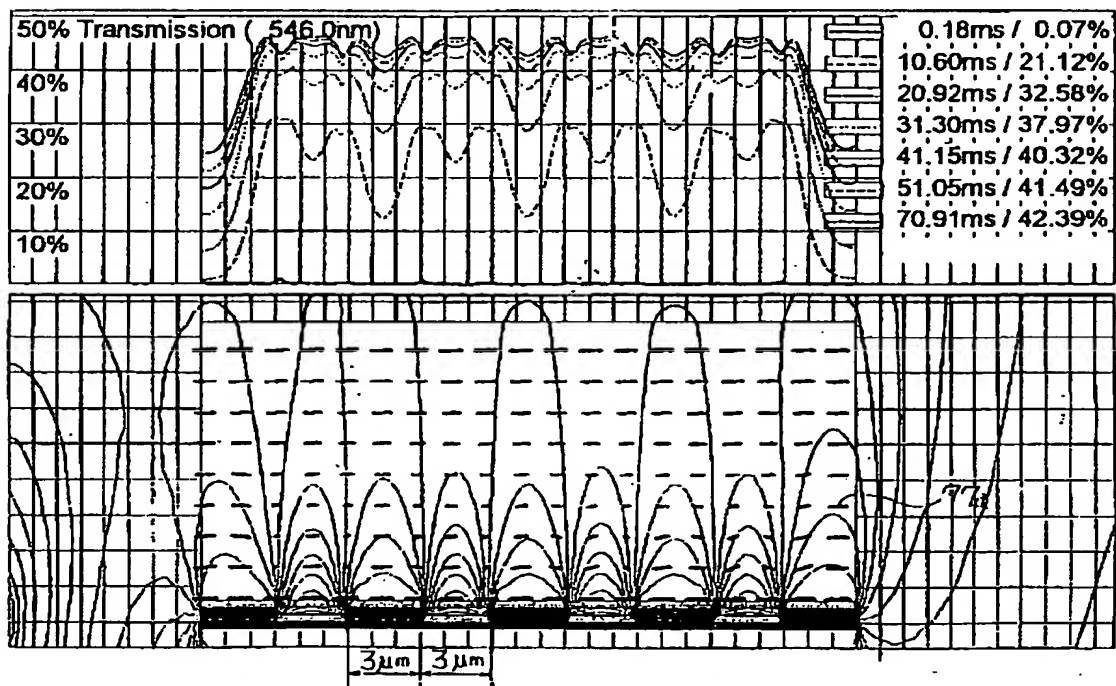
【図 20】



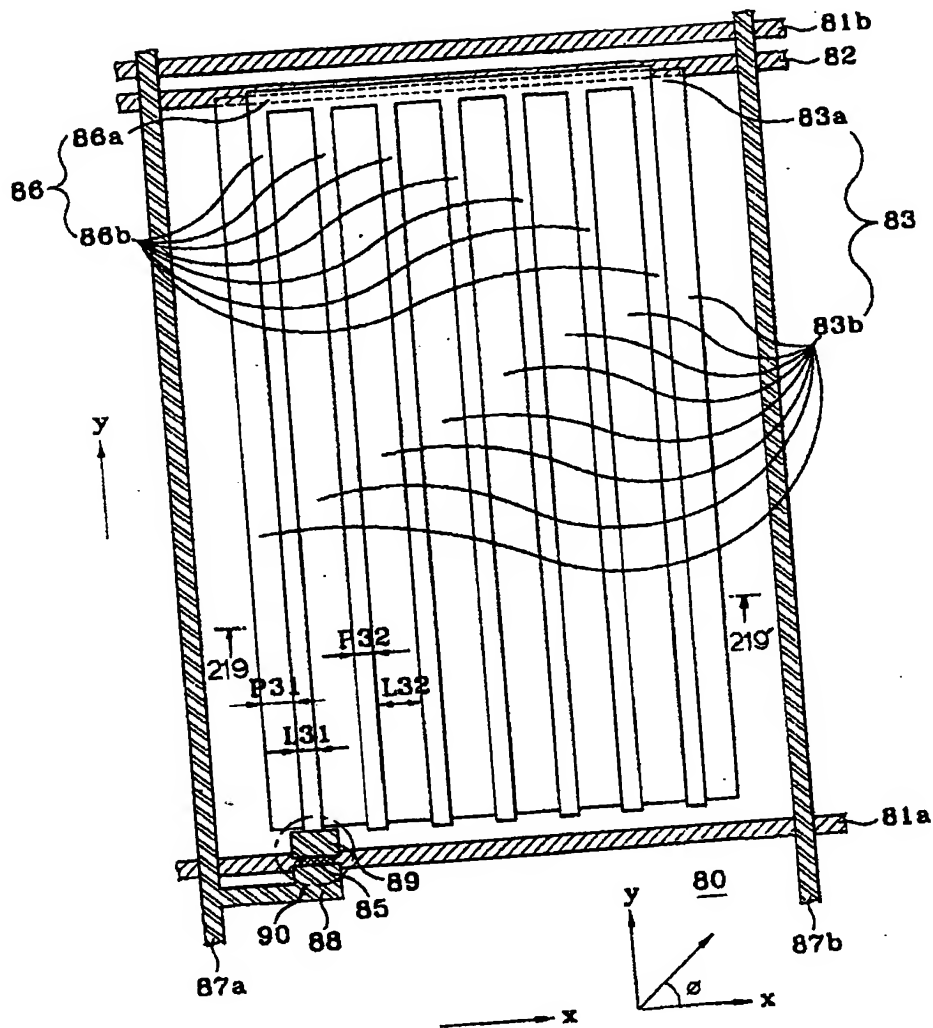
【図22】



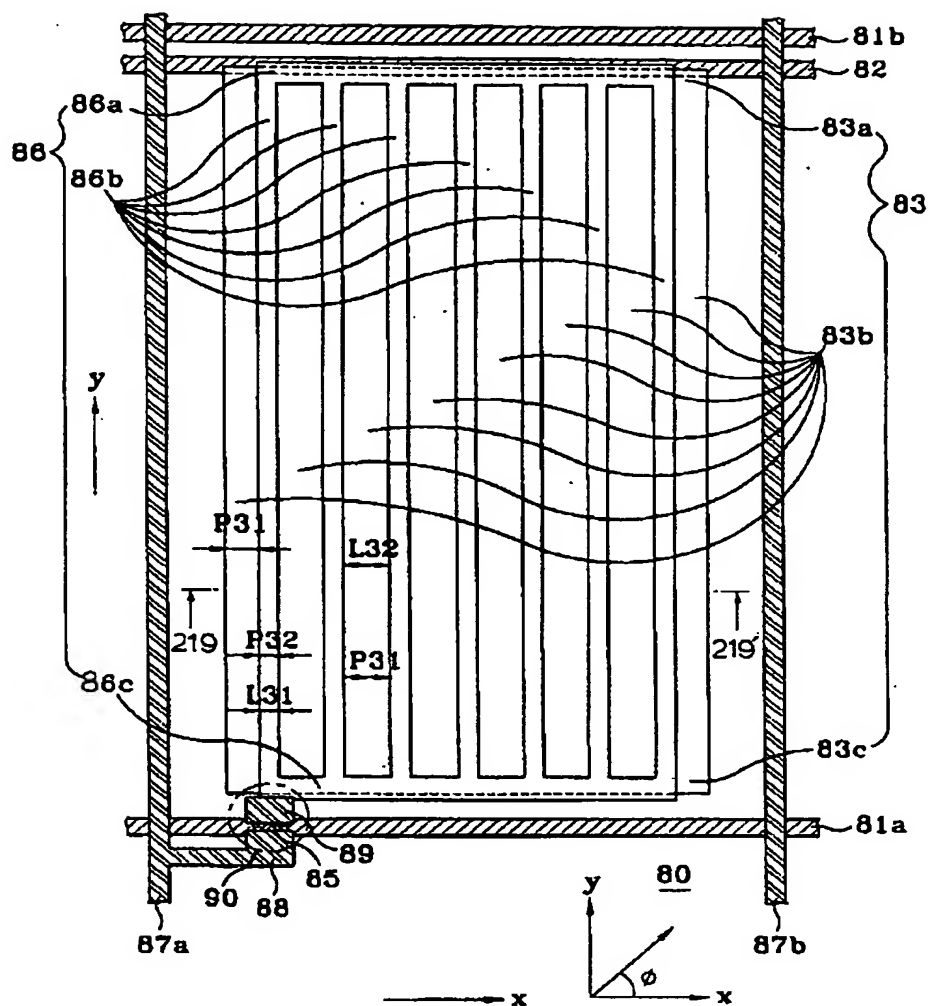
【図23】



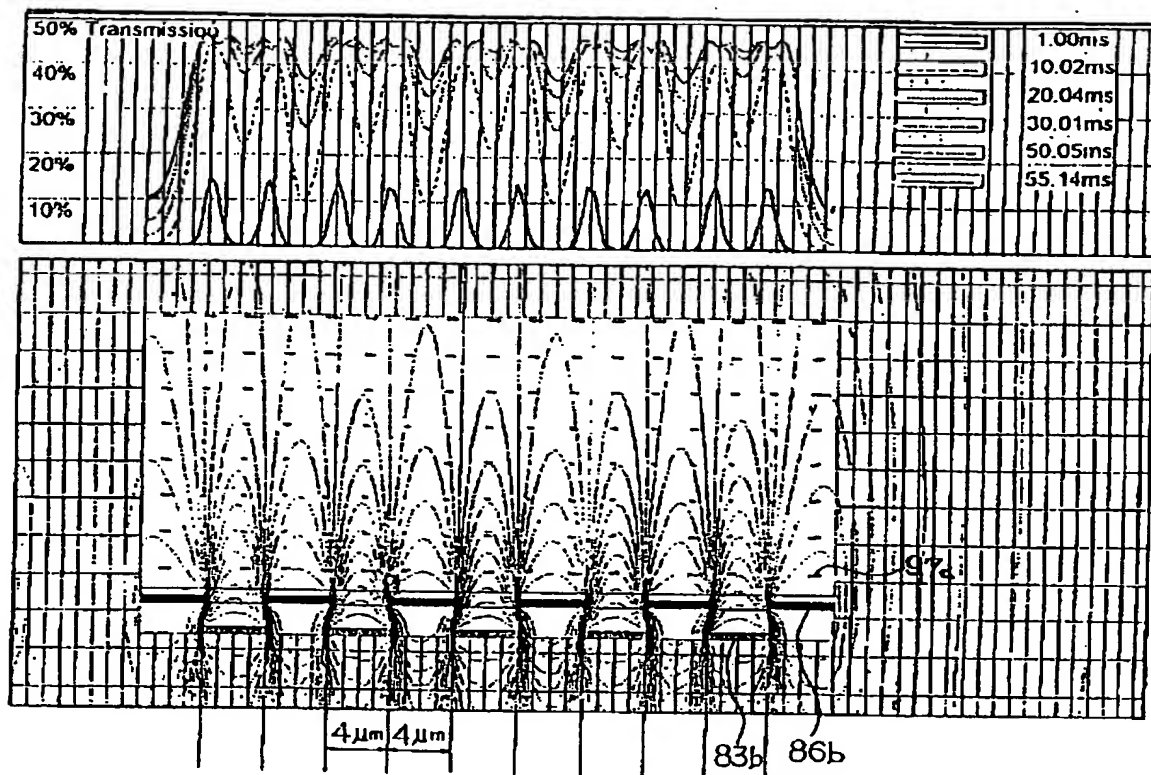
【図24】



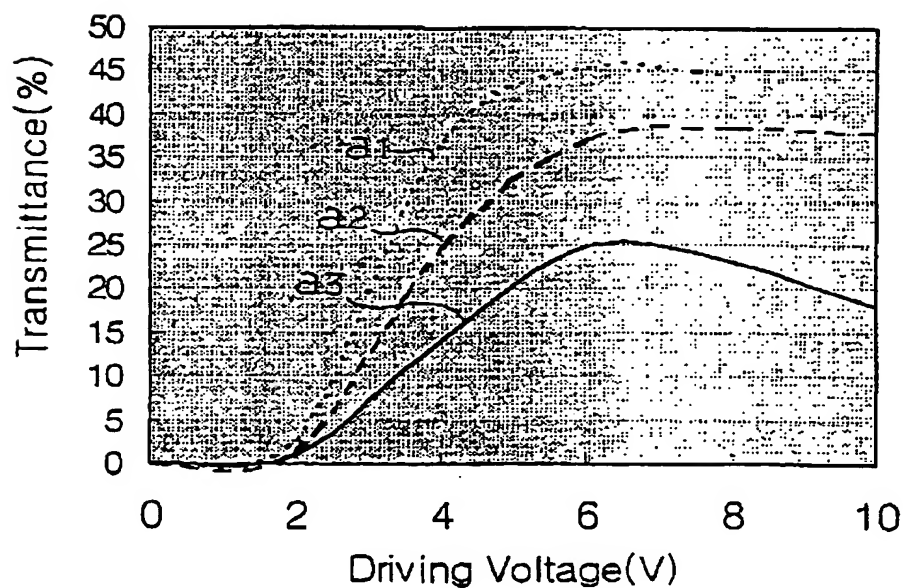
【図25】



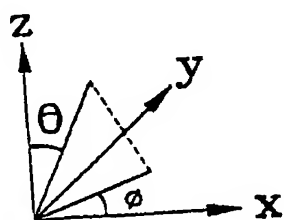
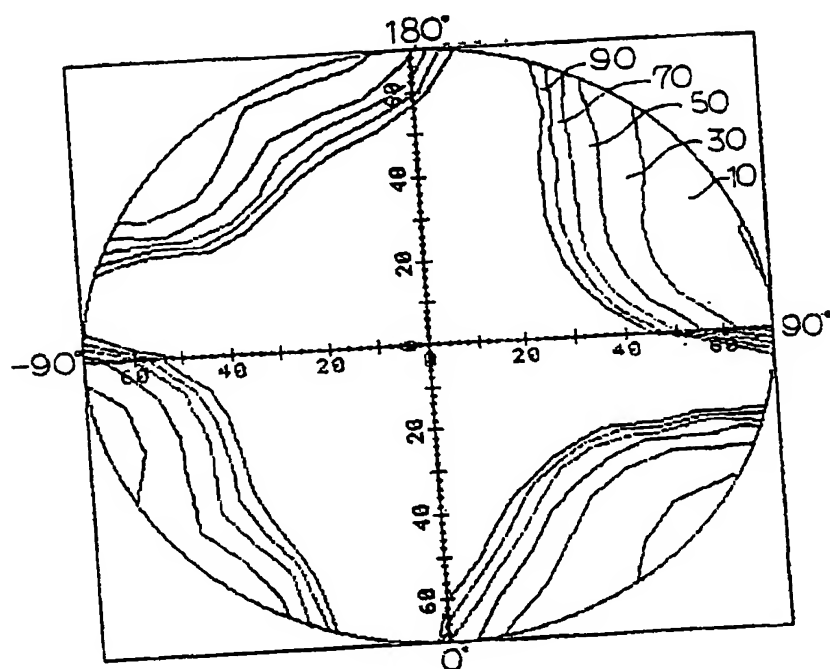
【図27】



【図31】

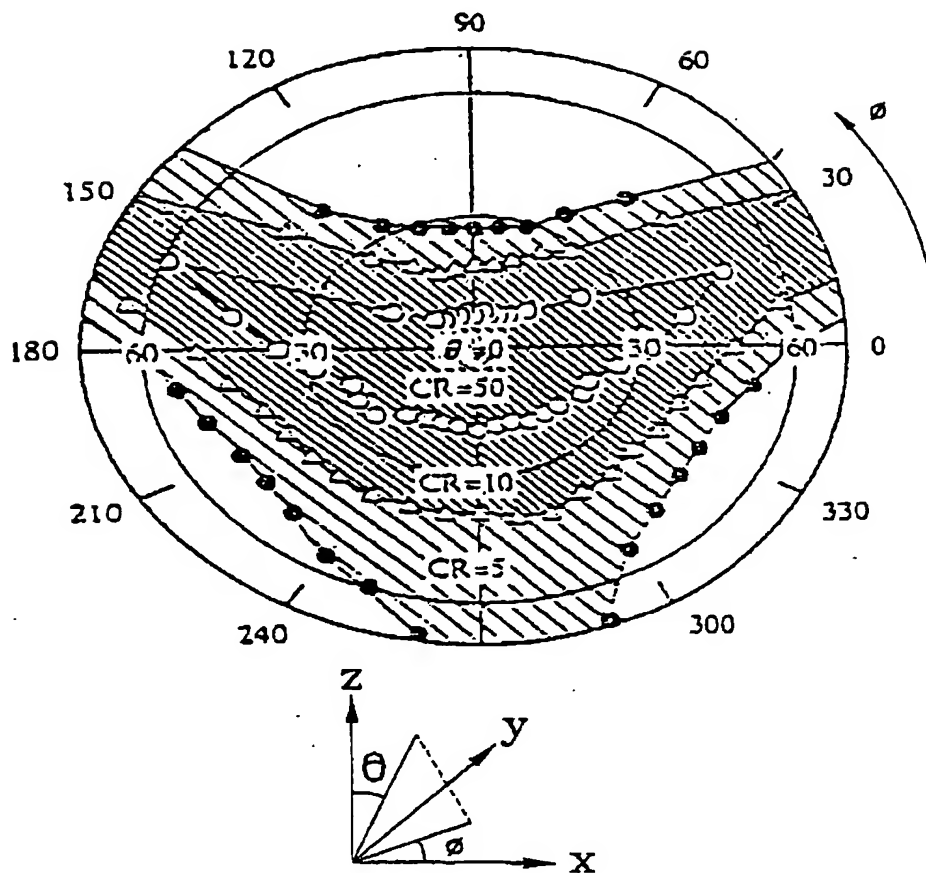


【図28】



90:CR=90
70:CR=70
50:CD=50
30:CR=30
10:CR=10

【図29】



【図30】

